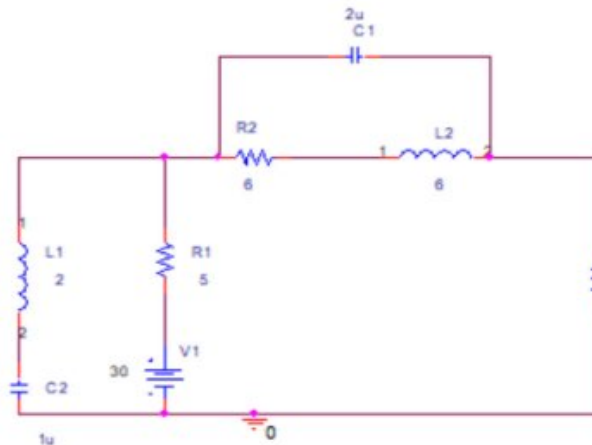


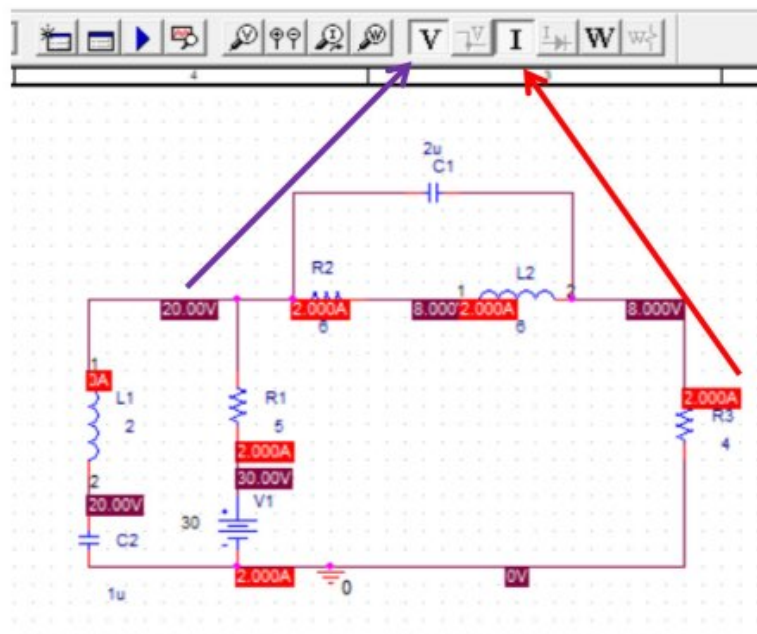
شبیه‌سازی سوالات ۱ و ۱۰ از تمرین شماره ۵ درس مدار ۱:

سؤال ۱:

در این سؤال می‌خواهیم ولتاژ خازن‌ها و جریان سلف‌ها در حالت ماندگار را به دست آوریم. برای اینکار نیاز به شبیه‌سازی خاصی نیست و تنها با استفاده از آیکون‌هایی که در شکل نمایش داده شده است، ولتاژ هر گره و جریان هر المان را ببینیم.



شکل ۱: شماتیک مدار سؤال ۱



شکل ۲: جریان‌ها و ولتاژهای هر المان. (جهت جریان در المان نیز با توجه به جایگاه مقدار جریان روی شکل مشخص است).

بنابراین ولتاژ هر خازن و جریان هر سلف در حالت ماندگار در جدول زیر نمایش داده شده است.

جدول ۱-۰: ولتاژ خازن‌ها و جریان سلف‌ها در حالت ماندگار برای سوال ۱

| المان | ولتاژ خازن یا جریان سلف |
|-------|-------------------------|
| L_1 | 0A |
| L_2 | 2A به سمت راست |
| C_1 | $20 - 8 = 12V$ |
| C_2 | $20 - 0 = 20V$ |

سؤال ۱۰:

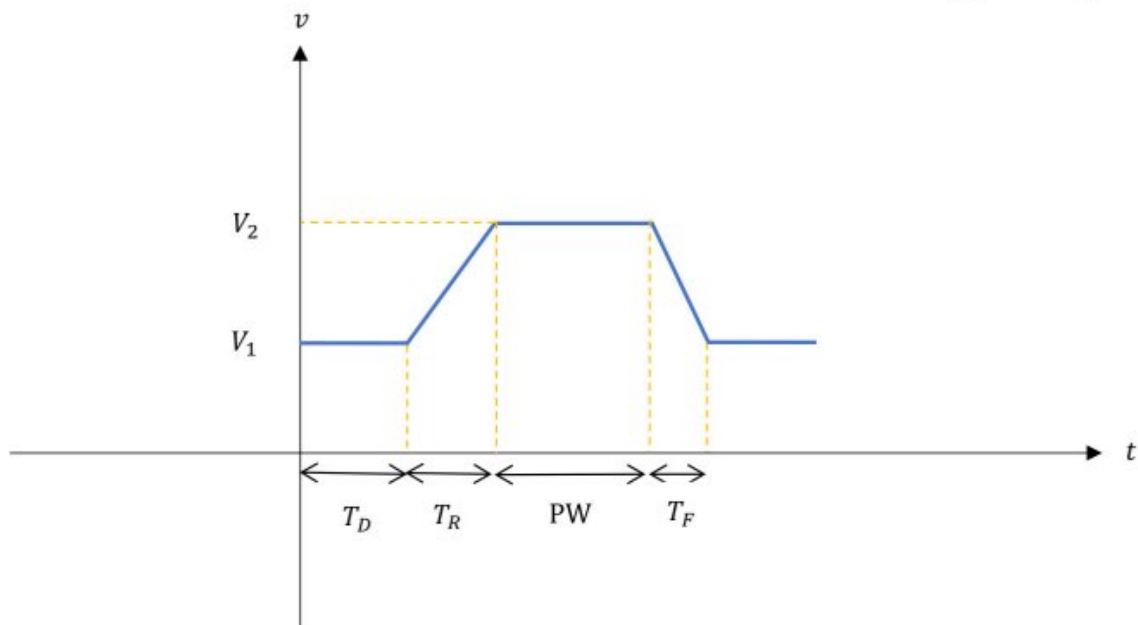
به دست آوردن پاسخ ضربه در آزمایشگاه:

برای اینکه بتوانیم پاسخ ضربه در آزمایشگاه را به دست آوریم، یک موج مربعی با فرکانس نسبتاً کم را مقدار duty cycle را تا حدی که می‌توانیم کاهش می‌دهیم. سپس دامنه این موج را نیز تا حدی که می‌توانیم زیاد می‌کنیم (باید توجه شود که در آزمایشگاه محدودیتی روی اندازه ولتاژ وجود دارد!).

تعیین فرکانس نسبتاً کم باید با توجه به ثابت زمانی مدار (مثلاً برای مدار مرتبه اول $T/2 > 5\tau$ که T دوره تناوب موج مربعی است.) صورت گیرد.

به دست آوردن پاسخ ضربه در شبیه‌سازی:

در شبیه‌سازی می‌توانیم با دقت بهتری کار کنیم. در ابتدا با استفاده از المان VPULSE منبع موجی که پالس تولید می‌کند را در مدار قرار می‌دهیم. این موج در محیط PSPICE با متغیرهایی مشخص می‌شود که در شکل زیر می‌توانید با این متغیرها آشنا شوید.



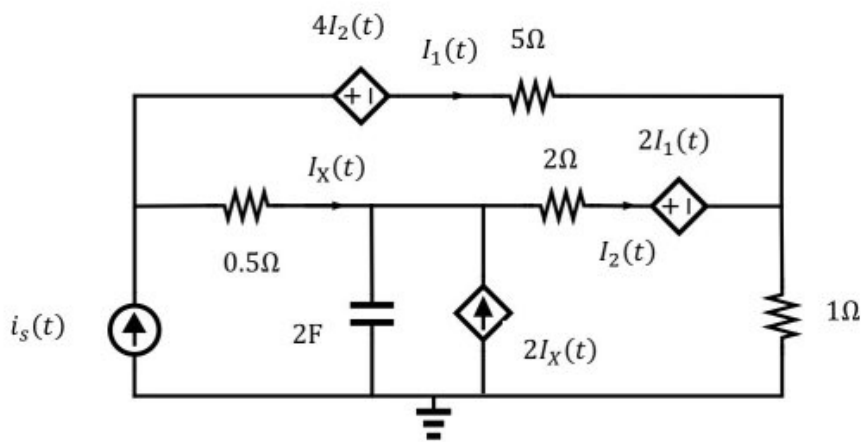
حال برای به دست آوردن پاسخ پله کافی است مقدار T_R را کاهش داده و مقدار PW را تا زمانی بزرگتر از زمان شبیه‌سازی زیاد کنید.

برای به دست آوردن پاسخ ضربه برای این که تا حد خوبی بتوانیم به تئوری نزدیک شویم، مقدار T_F و همینطور T_R را تا مقدار بسیاری کمی کاهش می‌دهیم و سپس با توجه به رابطه زیر میان V_2 و PW رابطه‌ای ایجاد می‌کنیم:

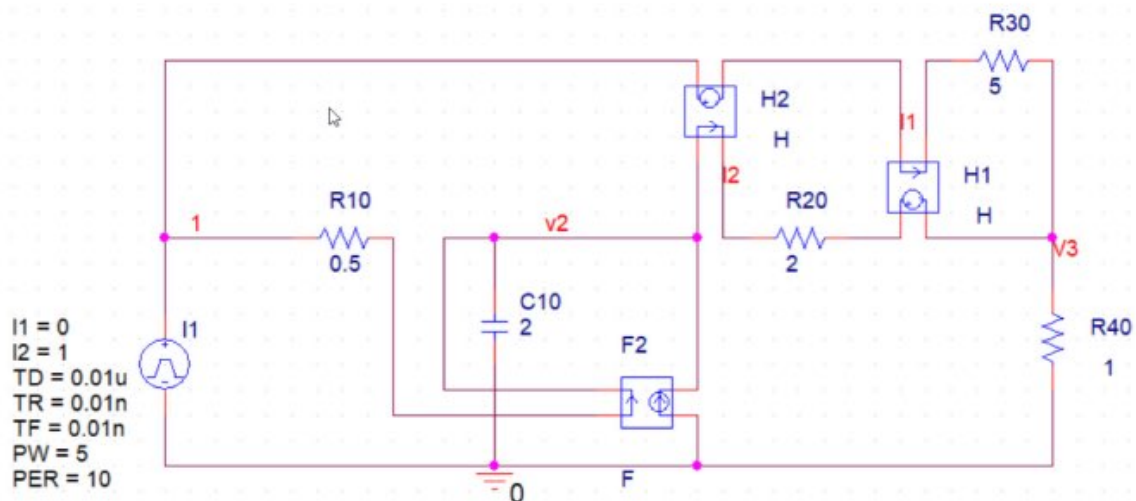
$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} (u(t) - u(t - \Delta)) \Rightarrow \Delta = PW, \quad \frac{1}{\Delta} = V_2, \quad V_1 = 0$$

به دست آوردن پاسخ پله $I_1(t)$:

می‌خواهیم برای مدار زیر پاسخ‌های خواسته شده را به دست آوریم:



شماتیک مدار در PSPICE به صورت شکل زیر می‌باشد:



شکل ۵: شماتیک مدار برای شبیه‌سازی پاسخ پله

چند نکته در مورد این شماتیک اهمیت دارد:

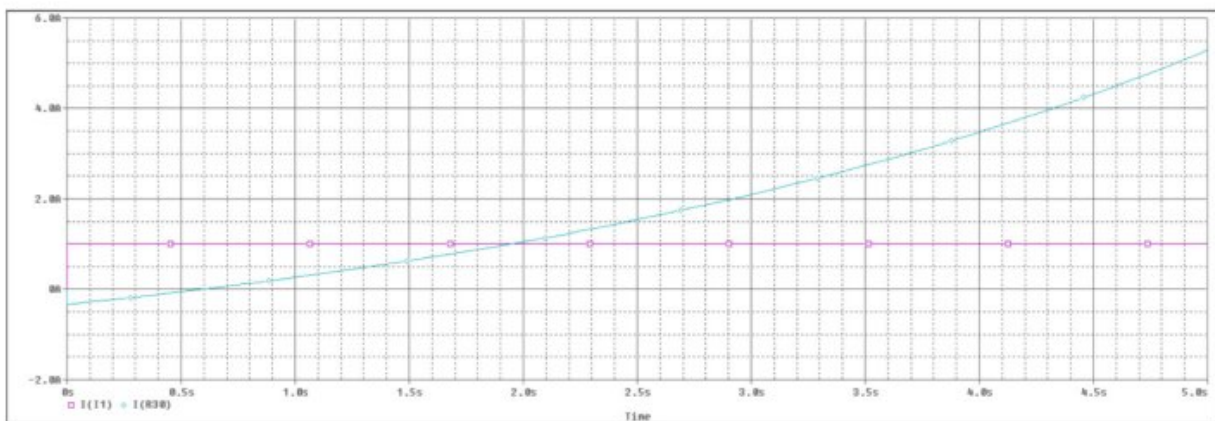
- ۱- همانند آزمایش برای اندازه گیری ولتاژ و جریان به وسیله مولتی متر، منابع وابسته به جریان لازم است به صورت سری در مدار و منابع وابسته به ولتاژ باید به صورت موازی در مدار قرار بگیرند.
- ۲- برای اینکه بهره منابع وابسته را مشخص کنید با استفاده از Double click و ستون Gain را مطابق خواسته مدار تغییر دهید:

| | BasValue | Power | Color | Designator | GAIN | Graphic | ID | Implementation | Implementation Path | Implementation Type | Name | Part Reference | PCB Footprint | Power Pins Visible | Primitive | PipicesOnly | Pin@REFDES % |
|---|---------------------|-------|---------|------------|------|----------|----|----------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|
| 1 | SCHEMATIC1:PAGE1:F2 | | Default | | 2 | F Normal | | | | resistor | R1706 | F2 | | | DEFAULT | TRUE | P1@REFDES % |
| 2 | F2 | 0.0 | Default | | 2 | F Normal | | | | resistor | R1706 | F2 | | | DEFAULT | TRUE | P1@REFDES % |

شکل ۶: مشخصات منابع وابسته

- ۳- از IPULSE در ورودی استفاده می کنیم.
- ۴- توجه کنید اگر حتی مدار را تحلیل هم نکنید و ندانید که ثابت زمانی مدار در چه اردری است، می توانید اردر زمان شبیه سازی را با مقادیر المانها تخمین بزنید. در اینجا خازن بسیار بزرگ و $2F$ است و مقادیر مقاومتها و بهره منابع وابسته نیز در اردر نهایت 10 می باشند. بنابراین به نظر می رسد زمان شبیه سازی در حدود ۵ ثانیه نتیجه قابل قبولی بدهد. بنابراین برای اینکه پاسخ پله را شبیه سازی کنیم همانطور که در شماتیک مشخص است مقدار PW را بزرگ می دهیم تا پایین رفتن پالس در شبیه سازی را نبینیم.

نتیجه به صورت زیر می باشد:



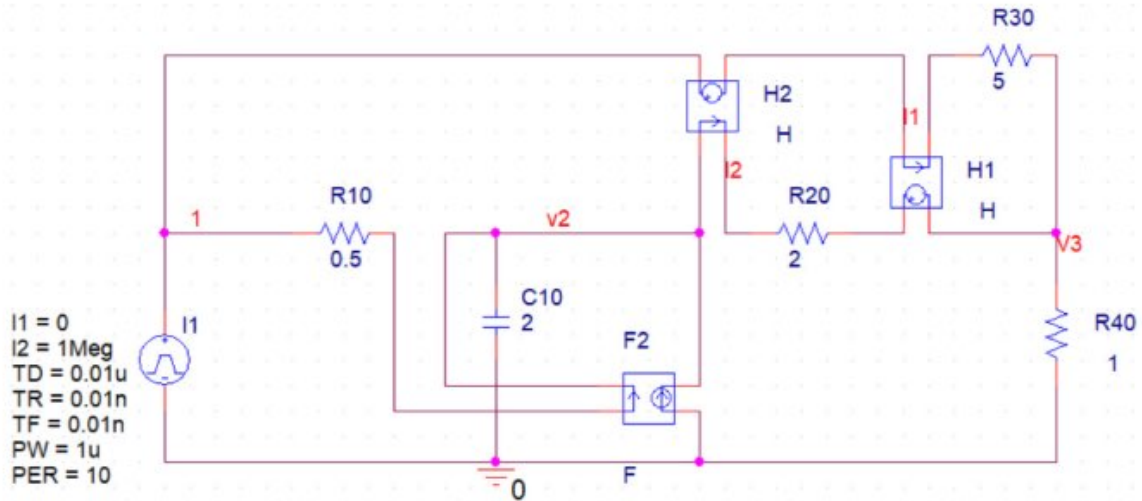
شکل ۷: بنفش جریان ورودی و سبز جریان خروجی را نمایش می دهد

به دست آوردن پاسخ ضربه $V_2(t)$:

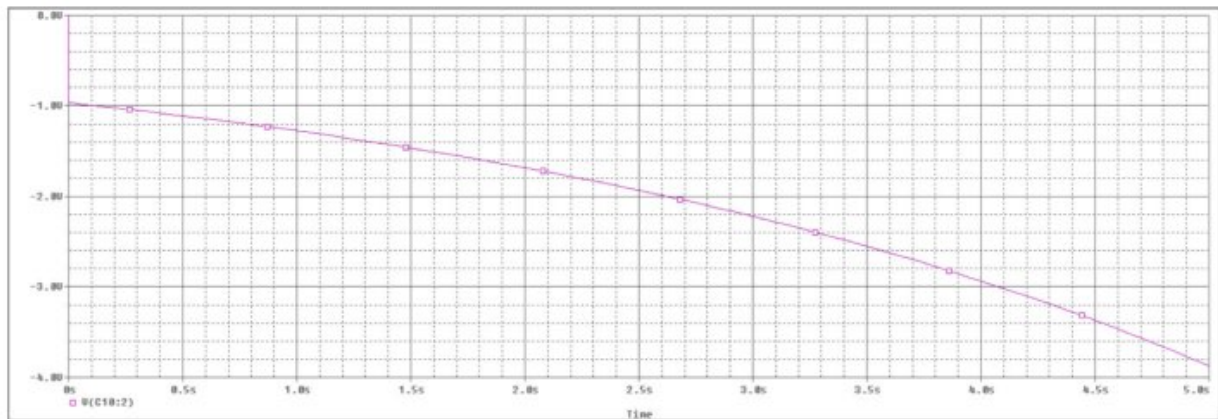
همانطور که توضیح داده شد عمل می‌کنیم:

مقدار $V_2 = 1\text{ MV}$ در نظر گرفته و مقدار $PW = 1\mu\text{s}$.

* توجه کنید که مقادیر T_R و T_F باید کمتر از مقدار PW باشند.

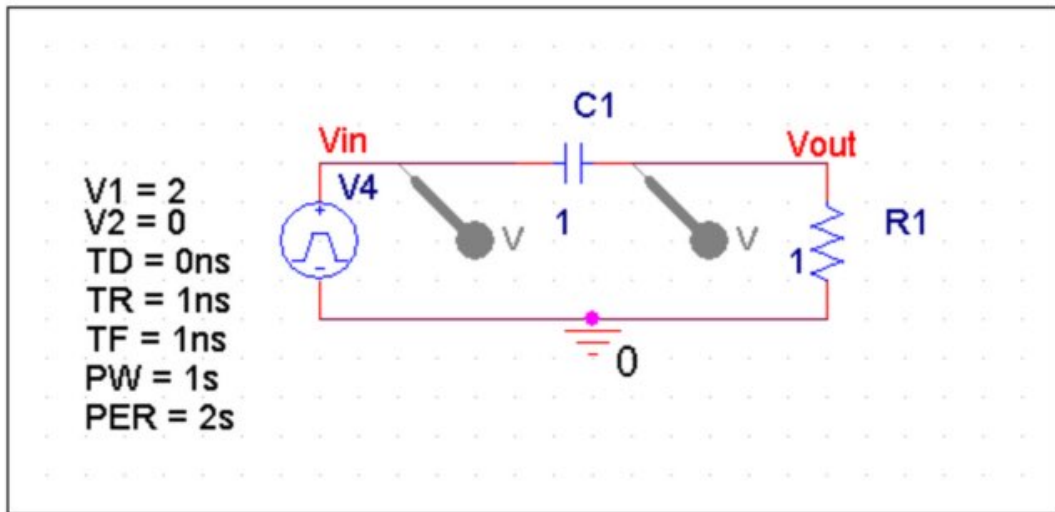


شکل ۸: شماتیک مدار برای پاسخ ضربه

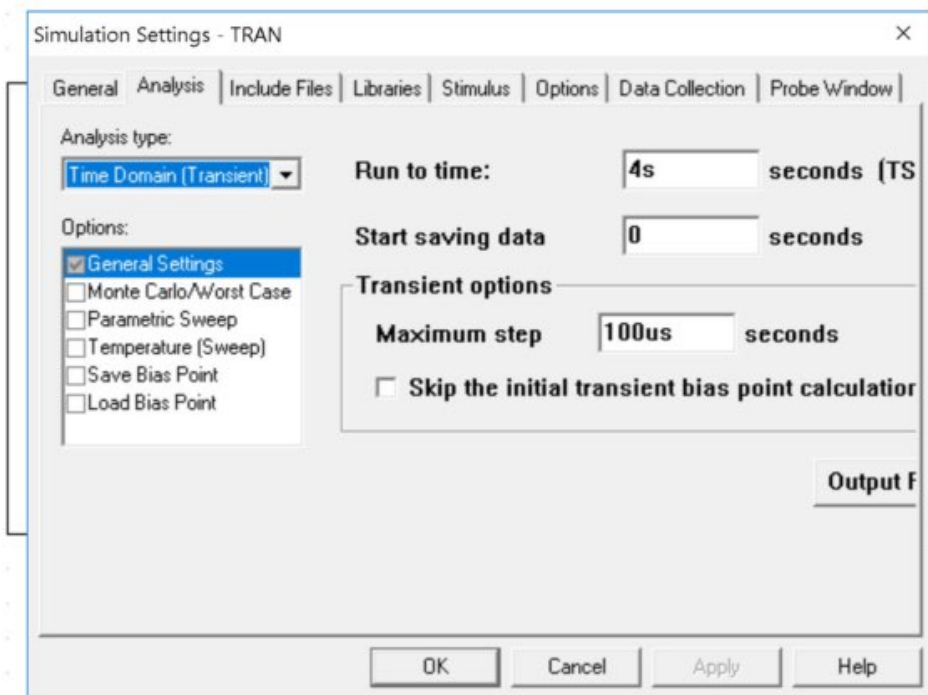


شکل ۹: خروجی پاسخ پله $V_2(t)$

سوال 9) مطابق صورت سوال شماتیک زیر را برای شبیه‌سازی حوزه زمان یا transient بوجود می‌آوریم:

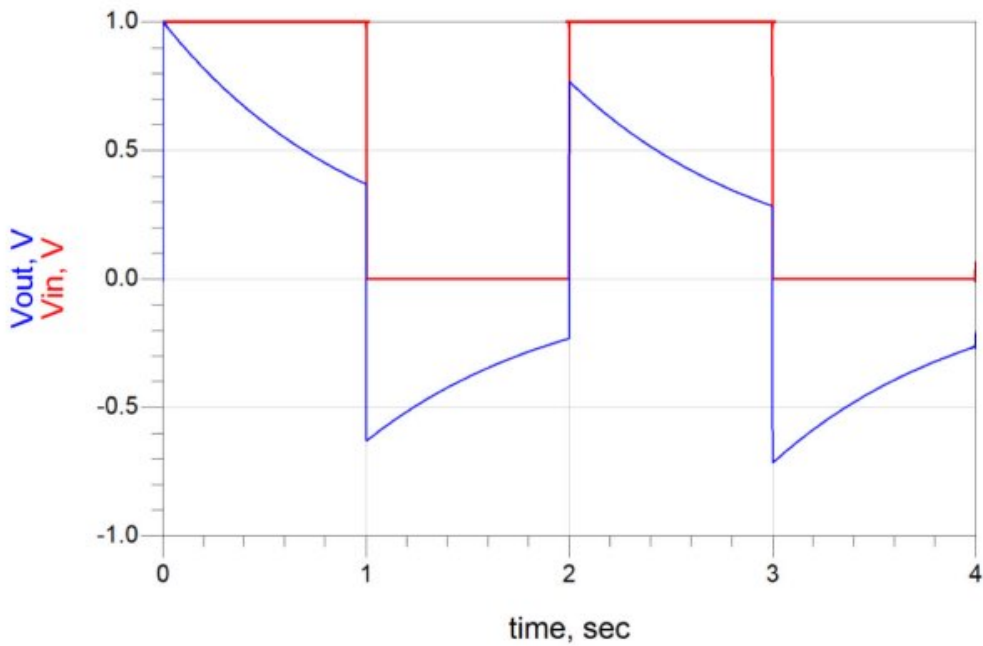


برای قسمت «الف» این سوال، شبیه‌ساز را بصورت زیر تنظیم می‌کنیم:

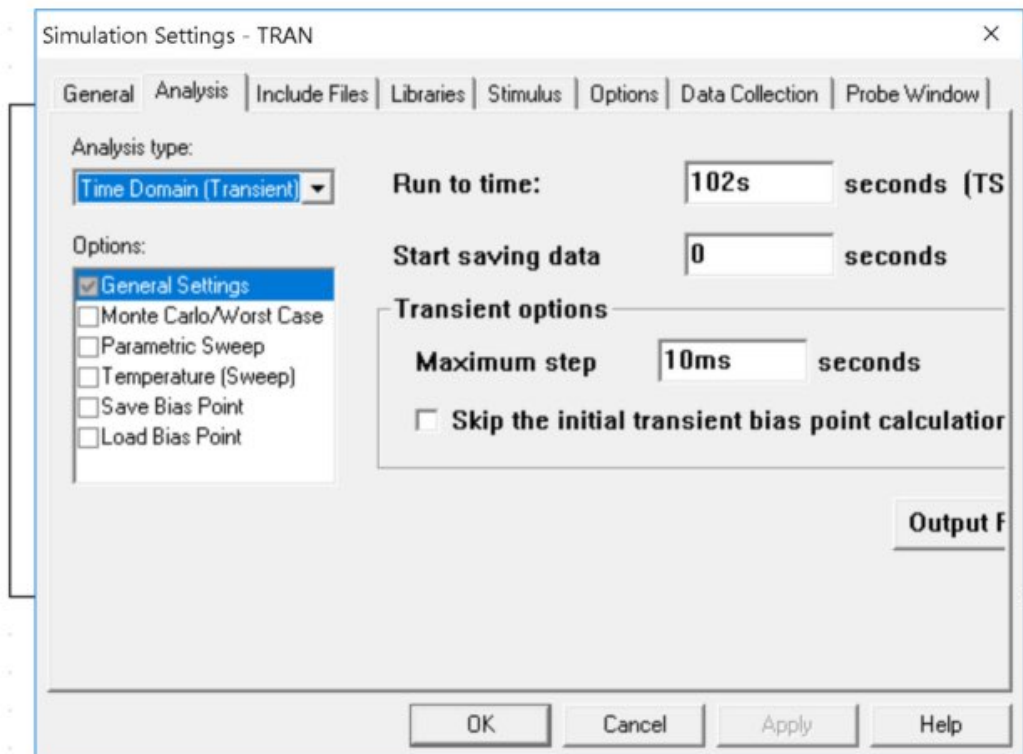


در نظر داشته باشید نام منبع vpulse هست و برای چشمپوشی بودن حالات گذر از 0 ولت به 2 ولت و برعکس، زمان صعود و سقوط (TR و TF) 1ns اختیار شده است، چرا که تجربیات شبیه‌سازی نشان می‌دهد بهتر است که این زمان گذر را خیلی کوچک تنظیم کنیم و نه صفر! همچنین با توجه به عدم نیاز تاخیر، TD اساساً 0ns اختیار شده است.

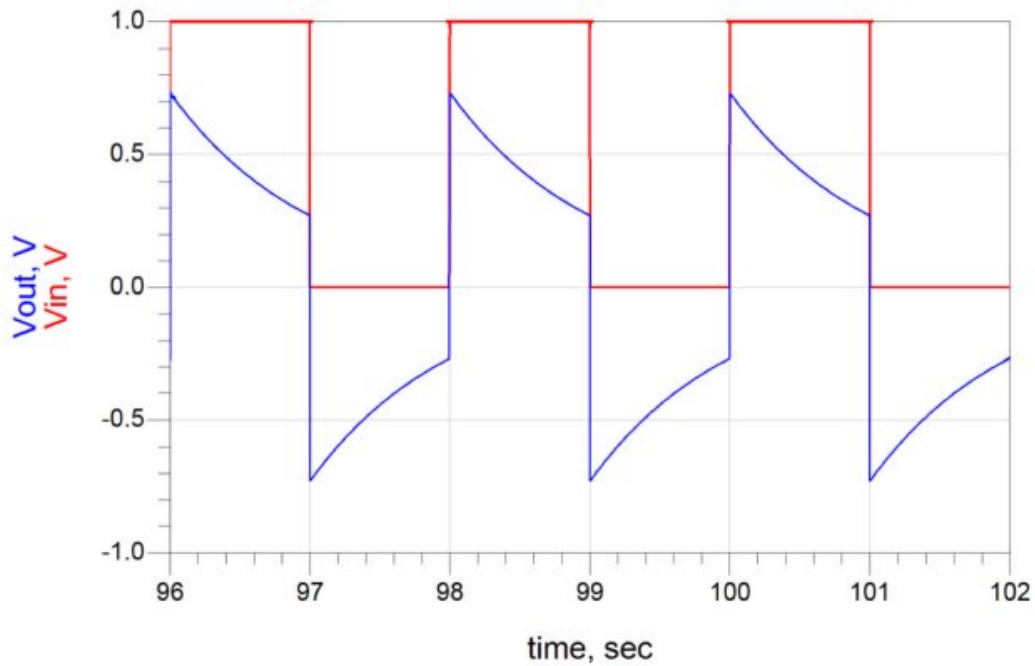
آنچه که حاصل می‌شود بصورت زیر است:



همچنین برای قسمت «ب»، شبیه‌ساز را بصورت زیر تنظیم می‌کنیم، تا در عین دقت کافی (گام‌های 0.01 ثانیه) فرایند شبیه‌سازی طولانی نگردد:

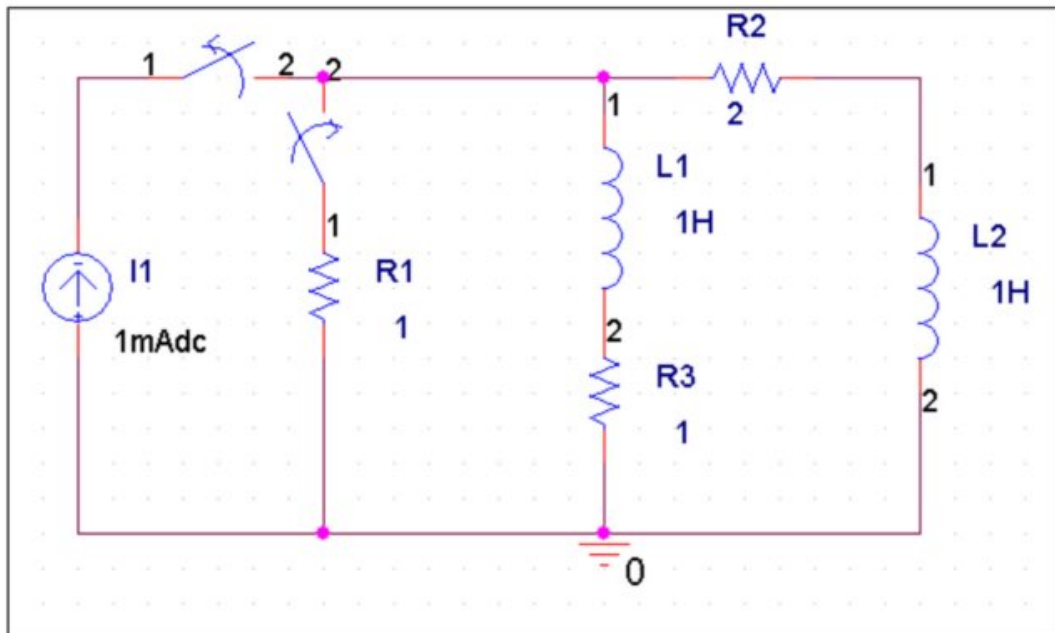


آنچه که حاصل می‌شود را با انتخاب پنجره‌ی 96 تا 102 ثانیه، به صورت زیر نمایش داده می‌شود (دیدن تمام بازه‌ی 0 تا 102 ثانیه اطلاعات مطلوبی را با توجه به درهم‌آمیختگی مقادیر به ما نمی‌دهد).



همانطور که مشاهده می‌شود، پس از مدت زمان کافی، مقدار بیشینه و کمینه‌ی سیگنال در هر پریود به مقدار ثابتی رسیده است و دوره‌ی گذار را پشت سر گذاشته است.

سوال 2) مطابق صورت سوال شماتیک زیر را برای شبیه‌سازی حوزه زمان یا transient بوجود می‌آوریم:



چند نکته‌ی مهم را بایستی در نظر گرفت:

- نخست اینکه این سوال بصورت پارامتری در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه چنین امری در نرم افزار PSPICE ممکن نیست، برخی مقادیر معمول بصورت دلخواه برای سلف‌ها و مقاومت‌ها اختیار شده‌اند.
- برای پیاده‌سازی چنین کلیدزنی شاید روش‌های بسیاری ممکن باشد، اما به یک روش ساده، می‌توان یک کلید بسته‌شونده و یک کلید بازشونده را به طرز فوق به‌کار گرفت. لازم به ذکر است که این نوع سوئیچ‌ها در کتابخانه‌ی ANL_MISC این نرم‌افزار شبیه‌سازی موجودند و نام آن‌ها به ترتیب Sw_tOpen و Sw_tClose می‌باشد. ضمناً نحوه‌ی تنظیم مقادیر این ابزاره که بسیار مهم است را در زیر می‌توانید ببینید:

| A | |
|---------------------|-----------------------------|
| | Example : PAGE1 : U4 |
| BiasValue Power | |
| Color | Default |
| Designator | |
| Graphic | Sw_tOpen.Normal |
| ID | |
| Implementation | Sw_tOpen |
| Implementation Path | |
| Implementation Type | PSpice Model |
| Name | 107119 |
| Part Reference | U4 |
| PCB Footprint | |
| Power Pins Visible | <input type="checkbox"/> |
| Primitive | DEFAULT |
| PSpiceOnly | TRUE |
| PSpiceTemplate | X*@REFDES %1 %2 @MO |
| RCLOSED | 0.01 |
| Reference | U4 |
| ROPEN | 1Meg |
| Source Library | C:\PROGRAM FILES\O... |
| Source Package | Sw_tOpen |
| Source Part | Sw_tOpen.Normal |
| TOPEN | 2 |
| TTRAN | 1n |
| Value | Sw_tOpen |

در این نوار، آنچه که برایمان اهمیت دارد مقادیر زیر هستند:

(1) RCLOSED: بیانگر میزان مقاومت این سوئیچ، در دورانی که بسته است. طبیعی است آن را مقدار بسیار کمی اختیار میکنیم تا رفتاری نزدیک به سیم داشته باشد. مثلاً در این‌جا 0.01 اهم.

(2) ROOPEN: بیانگر میزان این سوئیچ، در دورانی که باز است. طبیعی است آن را مقدار بسیار بزرگی اختیار کنیم تا رفتاری نزدیک به اتصال باز داشته باشد. مثلاً در این‌جا 1 مگا اهم.

(3) TOPEN: بیانگر لحظه‌ی کلیدزنی (باز شدن سوئیچ) است. با توجه به ساختار شبیه‌سازی این عدد را اختیار میکنیم. مثلاً به دلخواه در این شبیه‌سازی در لحظه‌ی $t = 2s$ این عمل صورت می‌گیرد.

(4) TTRAN: بیانگر مدت زمان گذر از حالت بسته بودن به باز بودن است. طبیعتاً انتظار داریم تا این اتفاق تا جای ممکن به سرعت رخ دهد تا شبیه به یک کلید ایده‌آل برایمان عمل کند. در این‌جا این زمان 1ns اختیار شده است که به میزان کافی کوچک و قابل صرف نظر است.

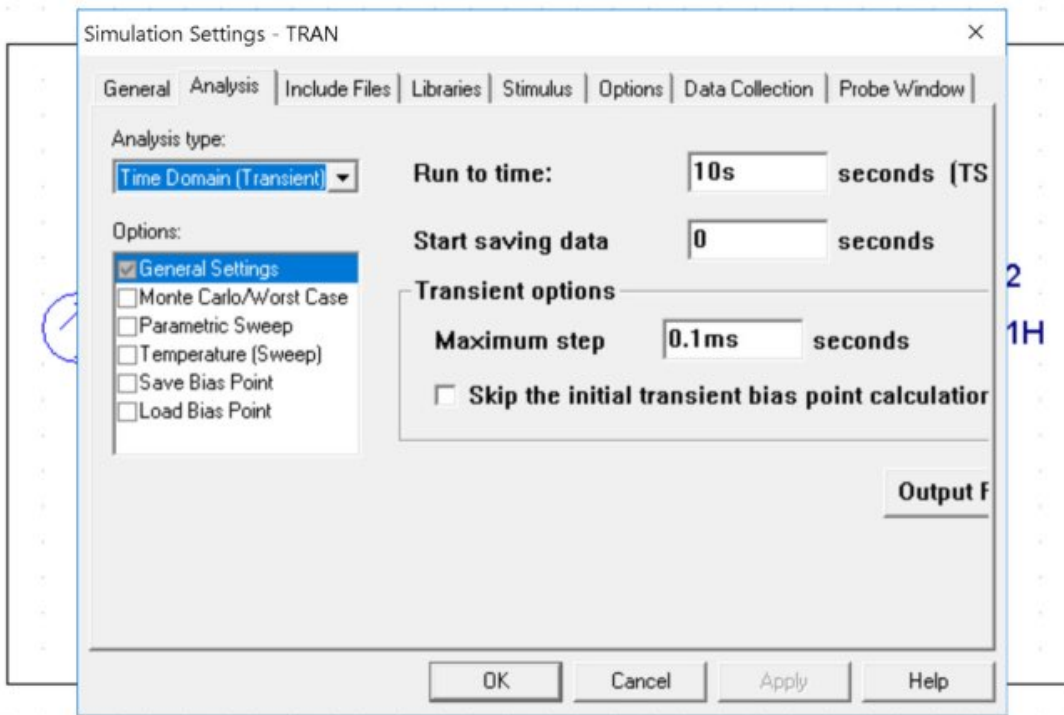
* برای Sw_tClose دو مورد اول فرقی ندارد و تنها برای مورد سوم، تعابیر باز و بسته شدن را جابجا در نظر بگیرید.

با توجه به مقدار بسیار بزرگ سلف و متناسباً ثابت زمانی بسیار بزرگ آن، اگر لحظه‌ی کلید زنی در $t = 2s$ رخ دهد، بررسی رفتار تا $t = 10s$ داده‌های کافی به ما می‌دهد.

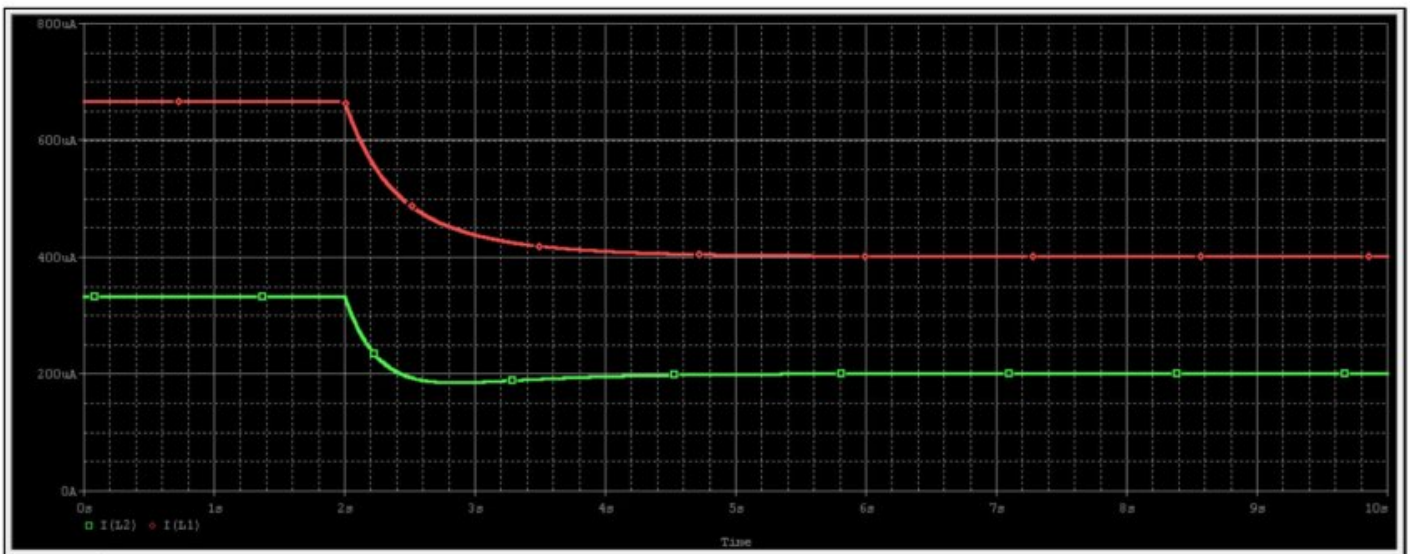
برای اطمینان مقادیر سلف و مقاومت بصورت زیر است:

$$R1 = 1 \text{ Ohm}, \quad R2 = 2 \text{ Ohm}, \quad R3 = 1 \text{ Ohm}, \quad L1 = 1 \text{ H}, \quad L2 = 1 \text{ H}, \quad I_{\text{source_dc}} = 1 \text{ mA}$$

به این ترتیب برای تنظیمات شبیه‌ساز خواهیم داشت:

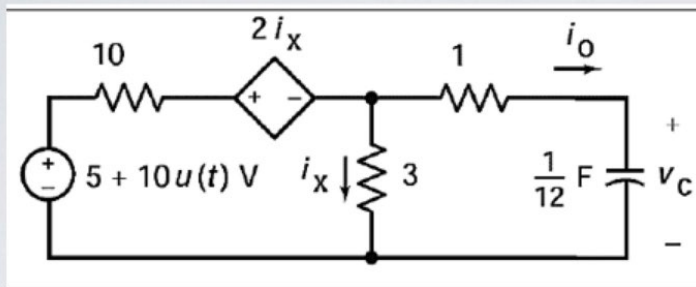


خروجی حاصل شده نیز به شکل زیر است:



***لازم به ذکر است که برای نمایش دقیق‌تر در تمرین 9، از یک عملگر دیگر برای رسم مقادیر حاصل شده بکار گرفته شد. این البته صرفاً به دلیل جنبه‌ی آموزشی آن بود و اساساً نتیجه هیچ تفاوتی با simulator اسپایس نخواهد کرد.

سوال ۳ تحویلی



$$t < 0 \text{ KVL} : 5 - 10i_x - 2i_x - 3i_x = 0 \rightarrow 5 = 15i_x \rightarrow i_x = 1/3$$

$$V_c(0^-) = 3i_x = 1v$$

$$t > 0 \quad V_c(0^-) = V_c(0^+) = 1v$$

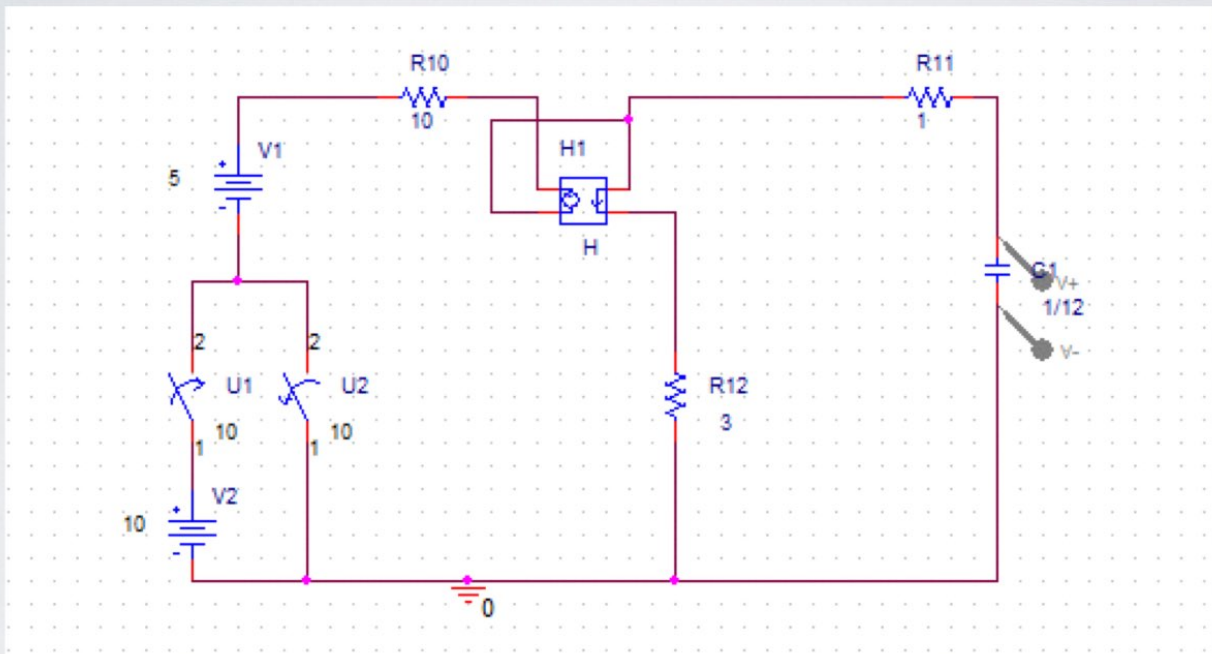
$$i_x = V_1/3, \text{ KCL} : \frac{V_1 - V_c}{1} + \frac{V_1}{3} + \frac{V_1 + 2\frac{V_1}{3} - 15}{10} = 0 \rightarrow 1.5V_1 - V_c = 1.5$$

$$V_1 = V_c + 1 * \frac{dV_c}{12dt} \rightarrow \frac{dV_c}{12dt} + \frac{V_c}{3} = 1,$$

$$V_c(0^-) = 1v \quad V_c(\infty) = 3v$$

$$V_c = 3 - 2e^{-4t}$$

مدار کشیده شده در شبیه سازی spice:



توضیحات پیاده سازی مدار:

- برای منبع ولتاژ وابسته به جریان از عنصر H موجود در کتاب خانه ANALOG استفاده می کنیم.
- برای تعیین میزان Gain آن ابتدا دو بار بر روی مدار کلیک می کنیم و در ستون gain مقدار مورد نظر را وارد می کنیم.
- در هنگام انجام اتصالات به جهت های ولتاژ و جریان توجه شود.
- برای کلید های از Sw-open و Sw-close موجود در کتاب خانه ANL-MISC استفاده می کنیم.
- برای تعیین میزان مقاومت این کلید ها در هنگام باز و بسته بودن به properties آن ها مراجعه می کنیم. مقدار پیش فرض این مقاومت ها برابر $1M\Omega$ و 0.01Ω است.
- لحظه باز یا بسته شدن کلید ها توسط مقدار t-open بر حسب ثانیه تعیین می شود. در این دو سوال این مقدار برابر ۱۰ ثانیه قرار داده شده تا مطمئن باشیم همه قسمت های گذرا به پایان رسیده اند. البته می دانیم که مدار timeinvariant است یعنی تاخیر در اعمال ورودی همان میزا تاخیر در خروجی را به همراه دارد. در نتیجه مشکلی ایجاد نمی شود.
- برای شبیه سازی منبع ولتاژ $5+10u(t)$ می توان به این صورت عمل کرد که ابتدا یک منبع 5vdc (از کتاب خانه source) قرار می دهیم. با یک کلیدی t-open به زمین وصل می کنیم. همچنین همان گره را با استفاده از یک کلید t-close به یک منبع ۱۰ ولت وصل می کنیم. اگر زمان باز شدن و بسته شدن کلید های ذکر شده همزمان باشد ولتاژ مورد نظر تولید شده است.

Sw-tclose properties

| A | |
|---------------------|--------------------------|
| | + Example : PAGE1 : U4 |
| BiasValue Power | |
| Color | Default |
| Designator | |
| Graphic | Sw_tOpen.Normal |
| ID | |
| Implementation | Sw_tOpen |
| Implementation Path | |
| Implementation Type | PSpice Model |
| Name | I07119 |
| Part Reference | U4 |
| PCB Footprint | |
| Power Pins Visible | <input type="checkbox"/> |
| Primitive | DEFAULT |
| PSpiceOnly | TRUE |
| PSpiceTemplate | X^@REFDES %1 %2 @MO |
| RCLOSED | 0.01 |
| Reference | U4 |
| ROPEN | 1Meg |
| Source Library | C:\PROGRAM FILES\O... |
| Source Package | Sw_tOpen |
| Source Part | Sw_tOpen.Normal |
| TOPEN | 2 |
| TTRAN | 1n |
| Value | Sw_tOpen |

← ROPE:resistance in SC

← ROPE:resistance in OC

← TOPEN:time to open the switch

H properties

| | BiasValue Power | Color | Designator | GAIN | Graphic | ID | Implementation |
|---------------------------|-----------------|---------|------------|------|----------|-----|----------------|
| ☐ SCHEMATIC1 : PAGE1 : H1 | | Default | | 2 | H.Normal | | |
| /H1 | 221.9mW | Default | | 2 | H.Normal | 333 | |

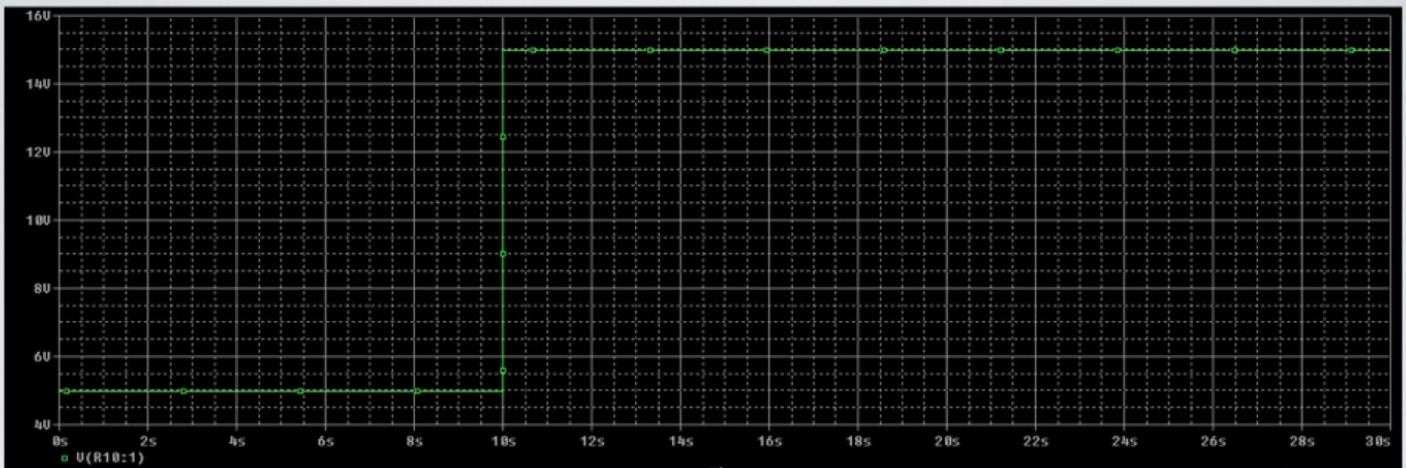
GAIN:Vout/lin

L and C properties

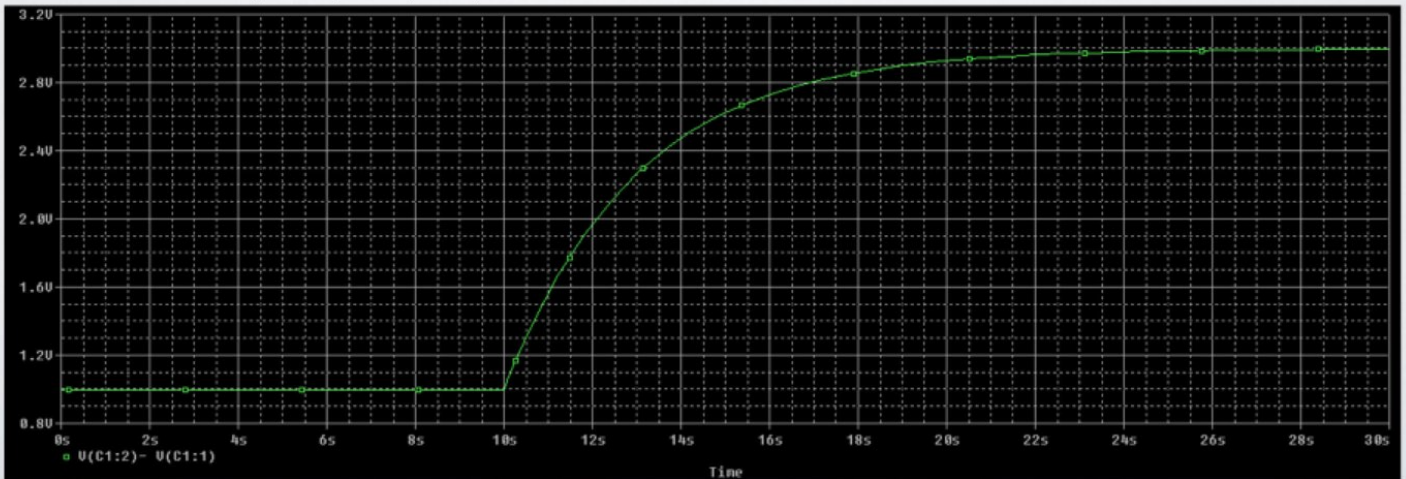
| | BiasValue Power | Color | Designator | Graphic | IC | ID | Implementation | Implementation Path | Implementation Type | Name | Part Reference | PCB Footprint | Power Pins V |
|---------------------------|-----------------|---------|------------|----------|----|-----|----------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|-------------------------------|--------------|
| ☐ SCHEMATIC1 : PAGE1 : L3 | | Default | | L.Normal | 0 | | | | <none> | /00944 | L3 | DISC/350x.175/LS.200x.100/034 | |
| /L3 | 9.090nW | Default | | L.Normal | 0 | 365 | | | <none> | /00944 | L3 | DISC/350x.175/LS.200x.100/034 | |

IC: you can change the initial voltage of capacitor and initial current of inductor

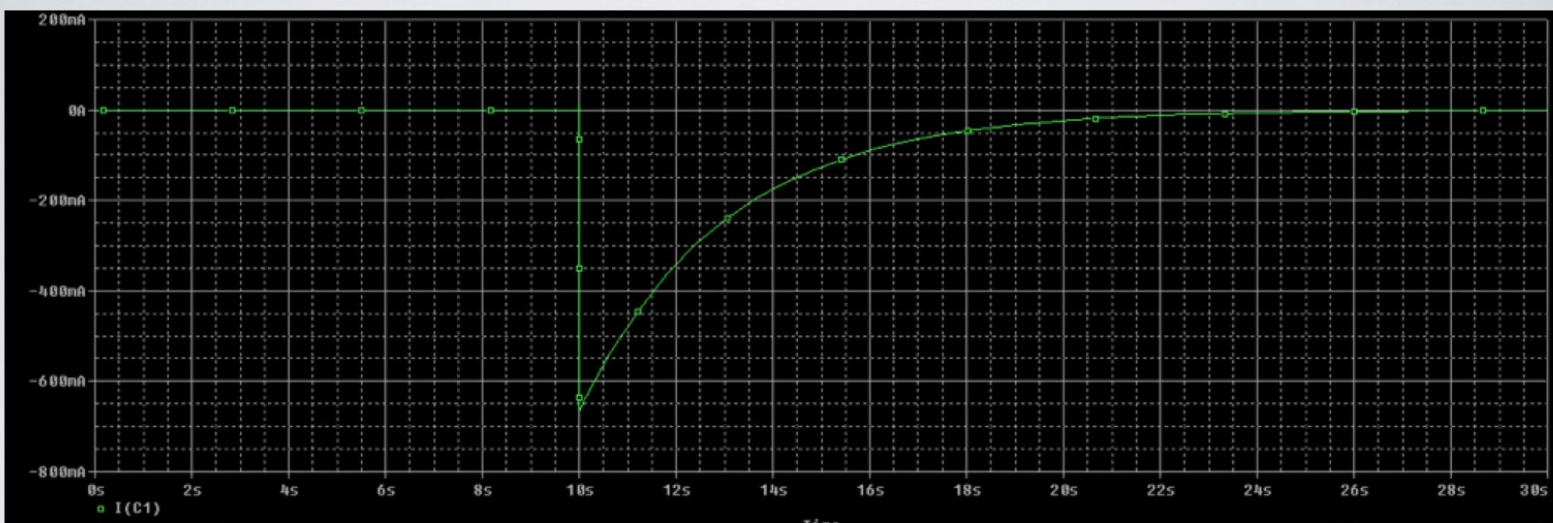
vin: 10 volt increase in voltage in t=0s



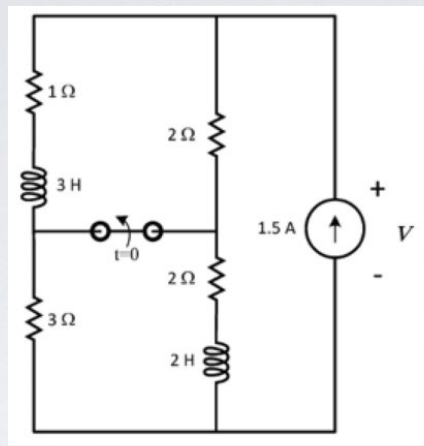
vout: $V(c:+) - V(c:-)$



برخلاف ولتاژ جریان خازن پیوسته نیست: I_C



سوال ۳ تحویلی



$$t < 0 \quad V = 1.5 * (2 || 1 + 2 || 3) = 2.8V, \quad V_1 = 1.8V$$

$$i_{L3}(0^-) = 1A, \quad i_{L2}(0^-) = 0.9A$$

$$t > 0 \quad KCL: \quad i_{L3} + i_{L2} = 1.5A$$

$$KVL = 3i_{L3} + 3 \frac{di_{L3}}{dt} + i_{L3} - 2i_{L2} - 2 \frac{di_{L2}}{dt} = 0$$

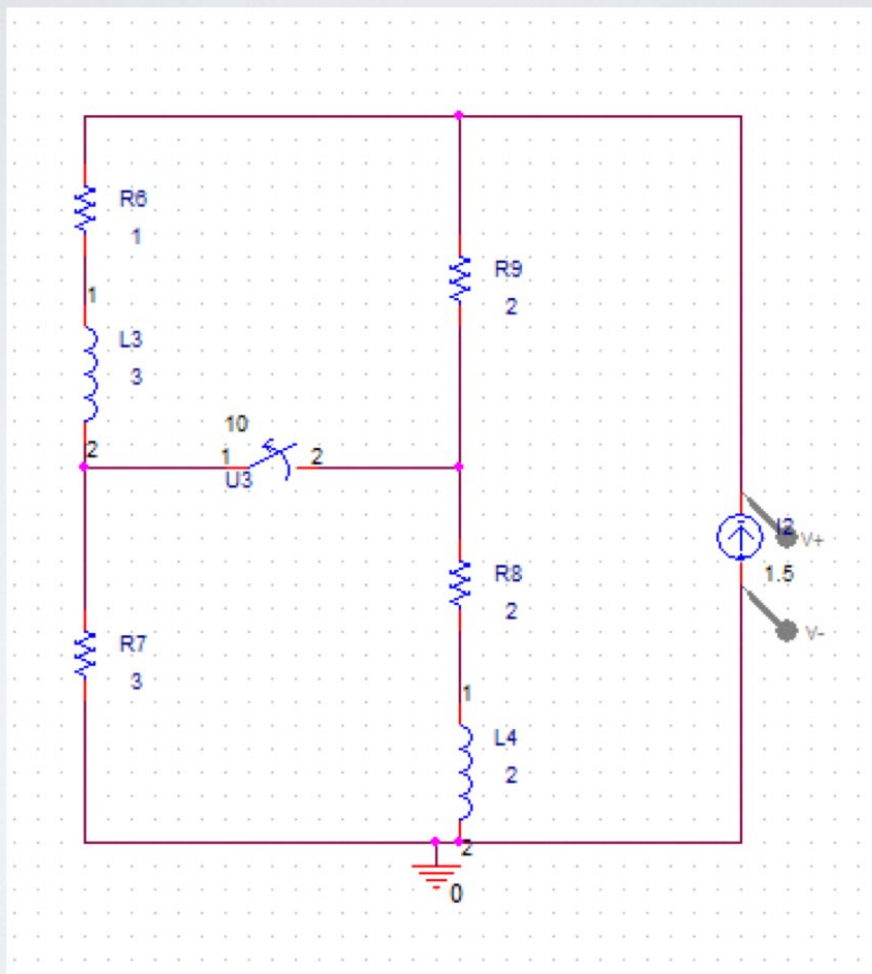
$$\int_{0^-}^{0^+} \rightarrow 0 + 3(i_{L3}(0^+) - i_{L3}(0^-)) + 0 - 2(i_{L2}(0^+) - i_{L2}(0^-)) + 0 = 0$$

$$3(i_{L3}(0^+) - 1) + 0 - 2(i_{L2}(0^+) - 0.9) + 0 = 0 \rightarrow$$

$$i_{L3}(0^+) = 0.84A, \quad i_{L2}(0^+) = 0.66A$$

$$t(\infty): \quad V = 1.5 * (4 || 4) = 3v$$

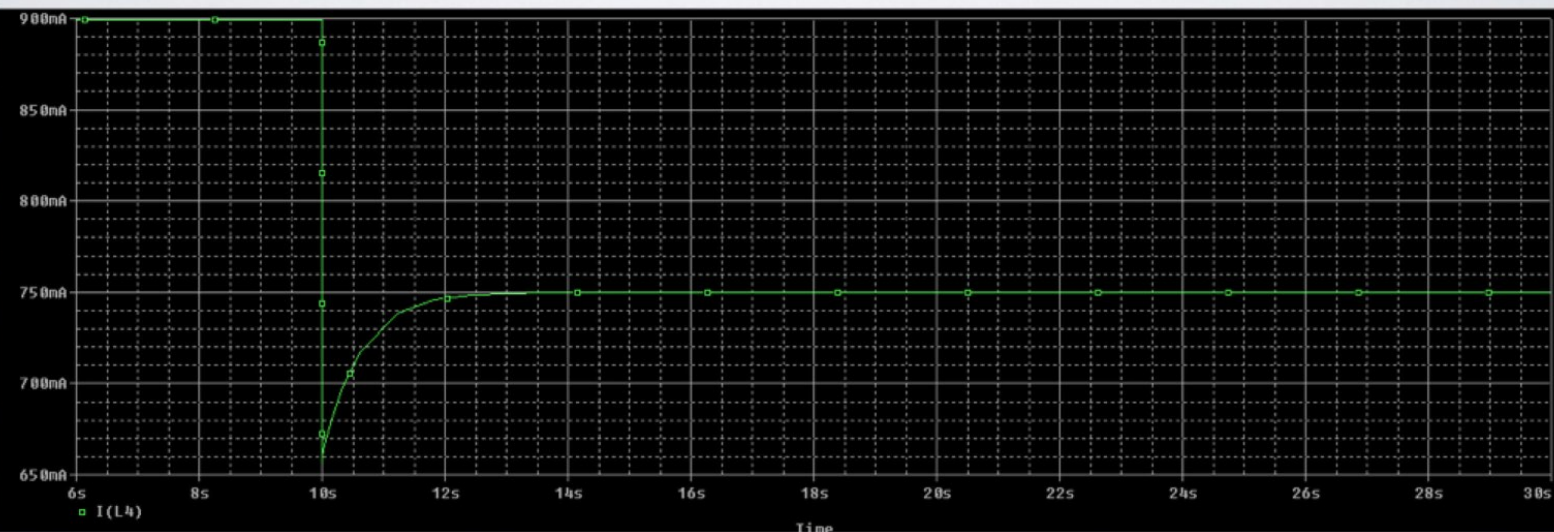
مدار کشیده شده در شبیه سازی spice:



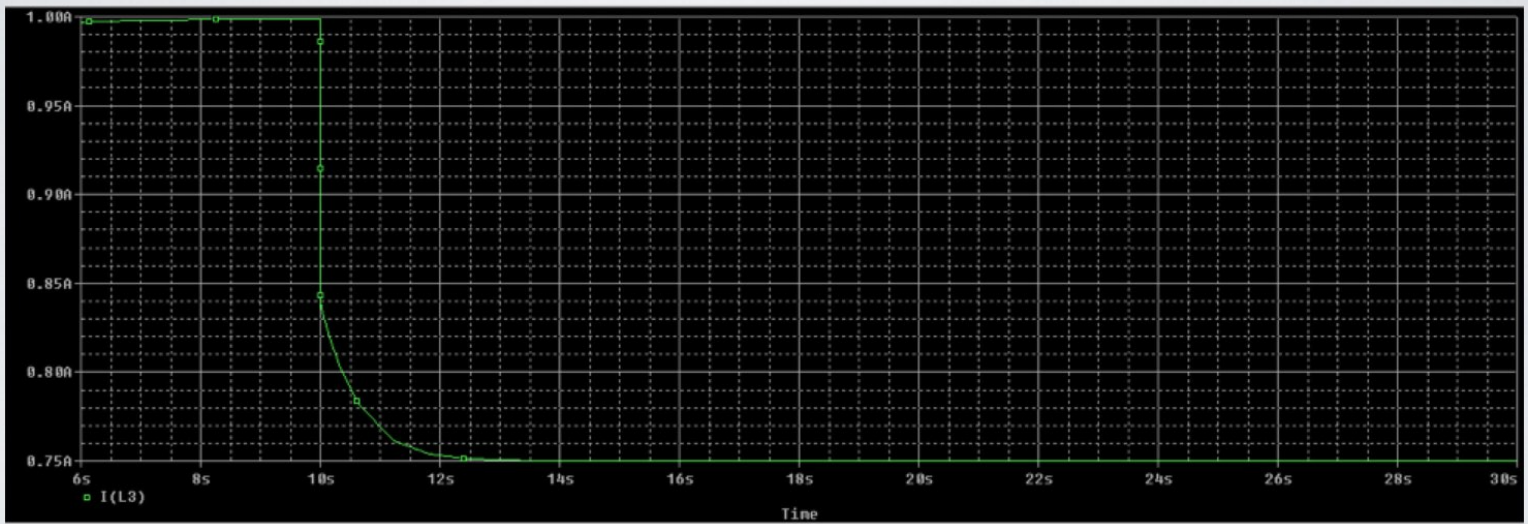
جریان سلف ها:

همان طور که در اسلاید قبل مشاهده کردید به علت ثابت بودن اندازه منبع جریان پس از باز شدن کلید یک ناپیوستگی در جریان سلف ها به وجود می آید. این ناپیوستگی منجر به ایجاد ولتاژ ضربه در لحظه صفر می شود. جریان سلف ها در شکل زیر نشان داده شده اند:

$$I(\text{initial})=0.9\text{A} \quad I(0^+)=0.66\text{A} \quad I(\text{final})=0.75\text{A}$$

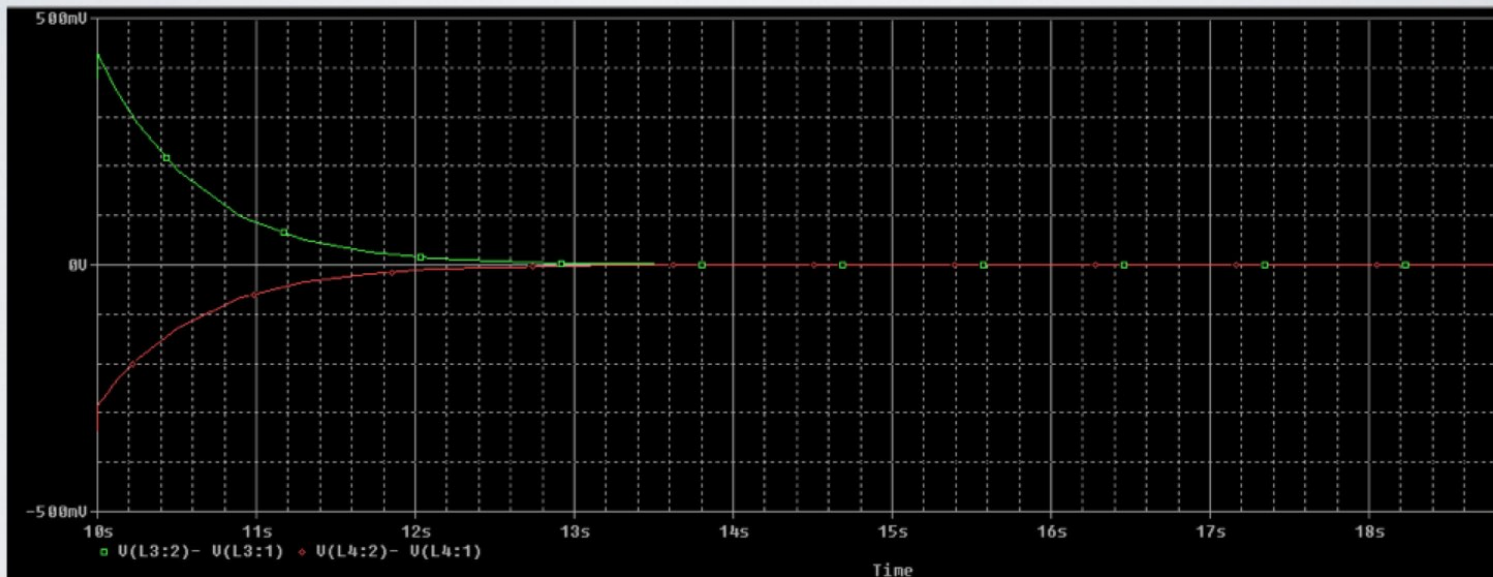


$$I(\text{initial}) = 1\text{ A} \quad I(0^+) = 0.85\text{ A} \quad I(\text{final}) = 0.75\text{ A}$$



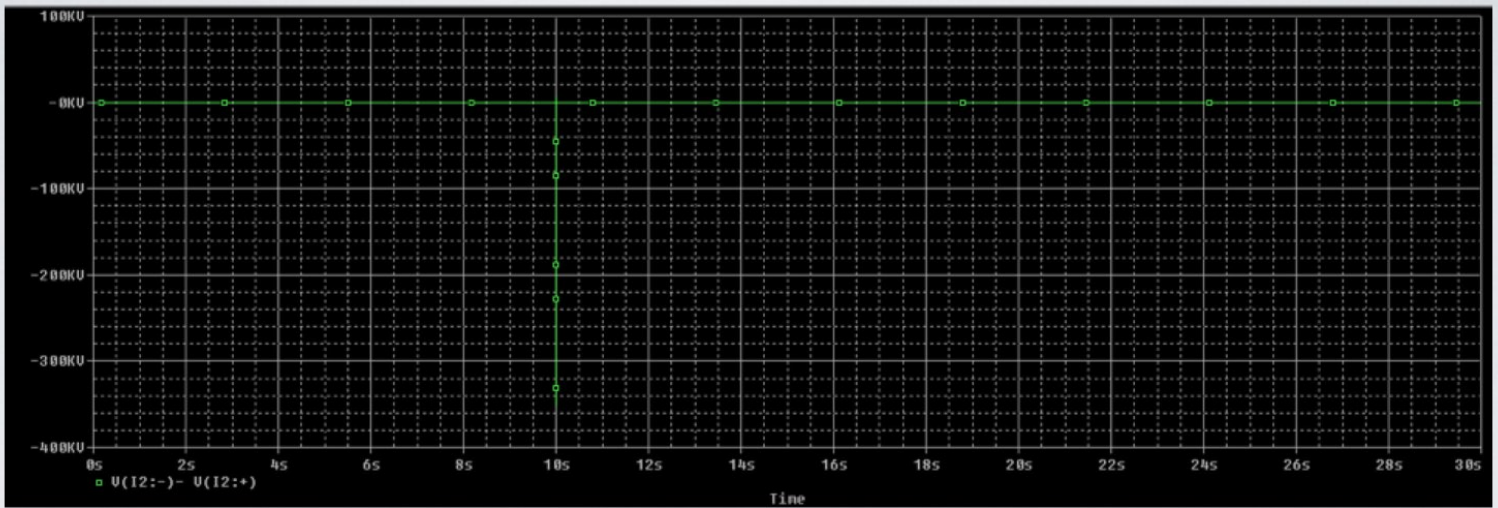
ولتاژ سلف ها

همان طور که قبلا اشاره شد پس از باز شدن کلید یک ناپیوستگی در جریان سلف ها به وجود می آید. برای برقرار بودن kV لازم است ولتاژ اولیه سلف ها برابر 560mV و 160mV شود. پس از پایان پاسخ گذرا ولتاژ دو سر آن مجددا صفر می شود. ولتاژ سلف ها در شکل زیر نشان داده شده اند :

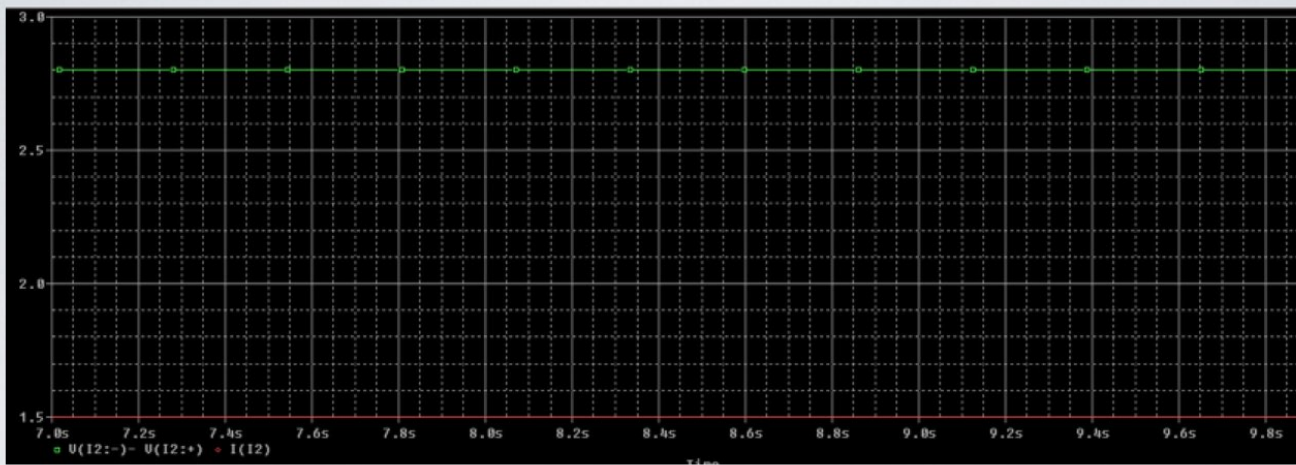


Vout

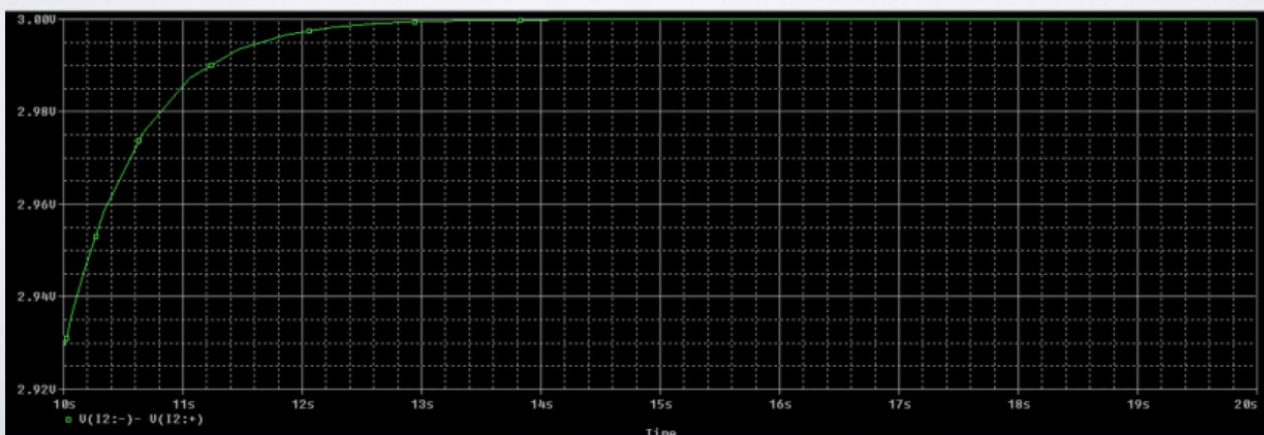
ولتاژ ضربه ایجاد شده در لحظه صفر به خوبی در شکل زیر مشخص است.



Vout: $t < 0$

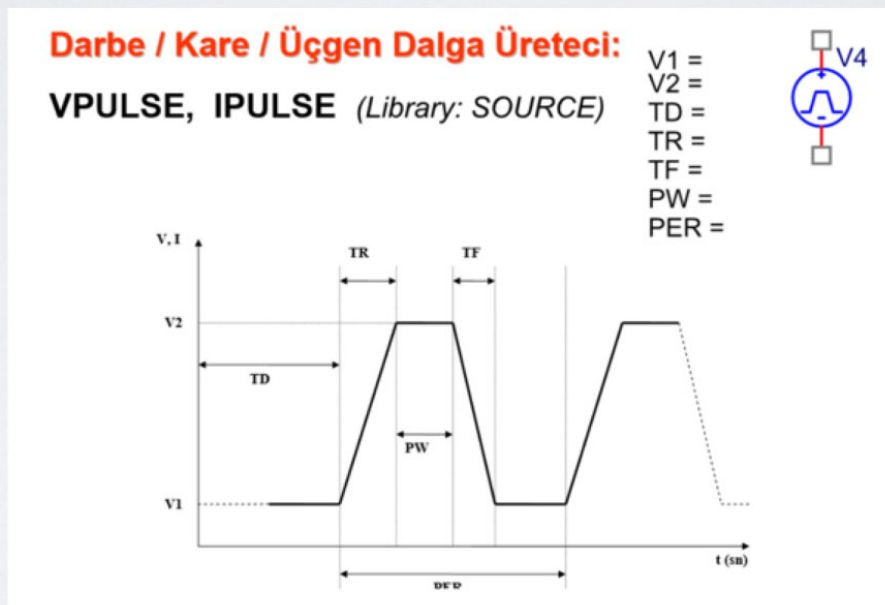


Vout: $t > 0$



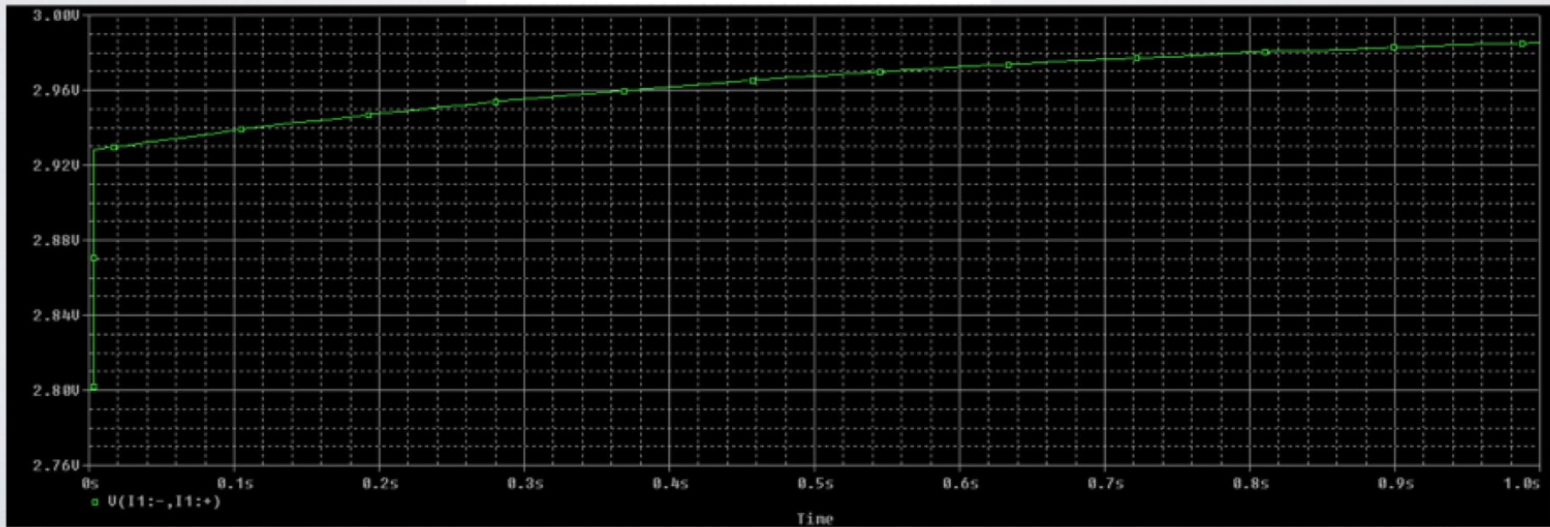
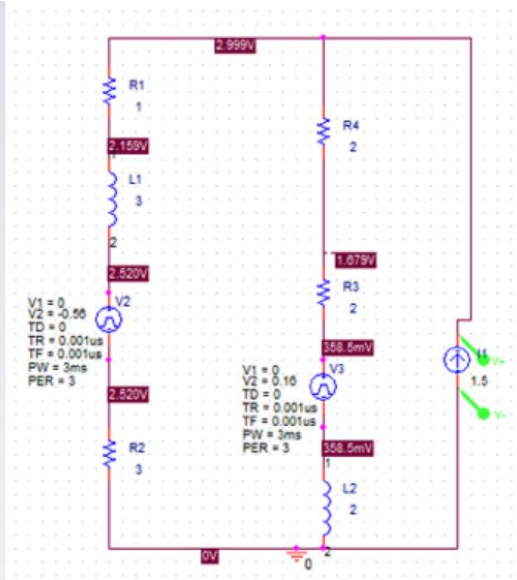
حال برای بهتر دیدن ولتاژ خروجی می توانیم تمام مقادیر اولیه های سلف از جمله جریان اولیه و ولتاژ ضربه ایجاد شده در آن ها را در لحظه باز شدن کلید شبیه سازی کنیم. نحوه اعمال این دو مورد با تغییر IC سلف ها (جریان اولیه سلف ها) و اعمال ولتاژ ضربه امکان پذیر است.

VPULSE properties



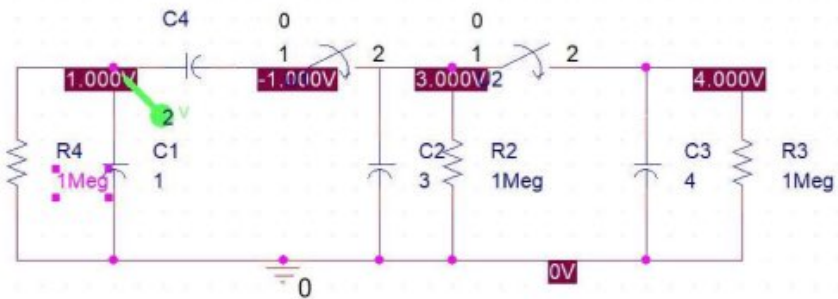
• برای شبیه سازی ولتاژ ضربه می توان از VPULSE استفاده کرد به این صورت که PR آن را به اندازه کل بازه شبیه سازی و PW آن را بازه زمانی بسیار کوچک در نظر می گیریم. همچنین دامنه آن باید تا حد ممکن بزرگ باشد.

Vout



به نام او

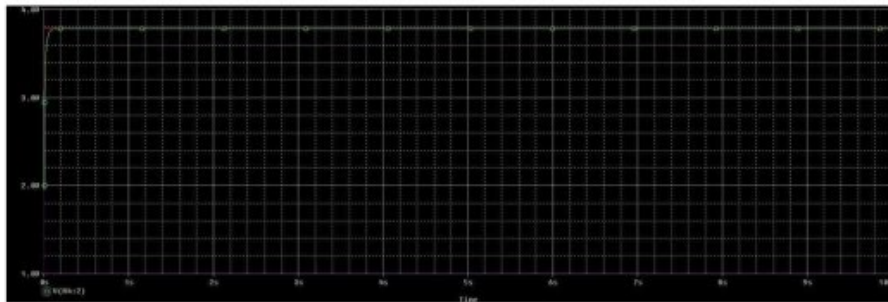
(1)



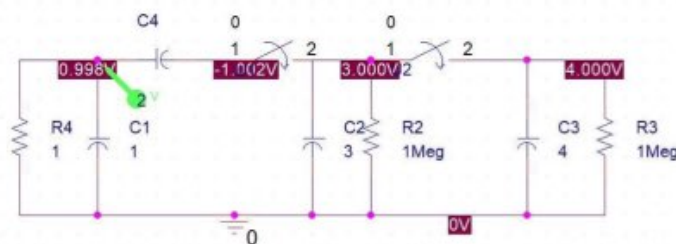
مدار را مانند شکل فوق در اسپایس می کشیم.

مقاومت ها برای شناور نشدن ولتاژ DC نقاط مدار قرار داده شده اند (گره ای که فقط توسط خازن ها به سایر نقاط مدار وصل شده باشد هر ولتاژ DC می تواند داشته باشد) و چون مقادیر بزرگی دارند می توان از آنها صرفنظر کرد.

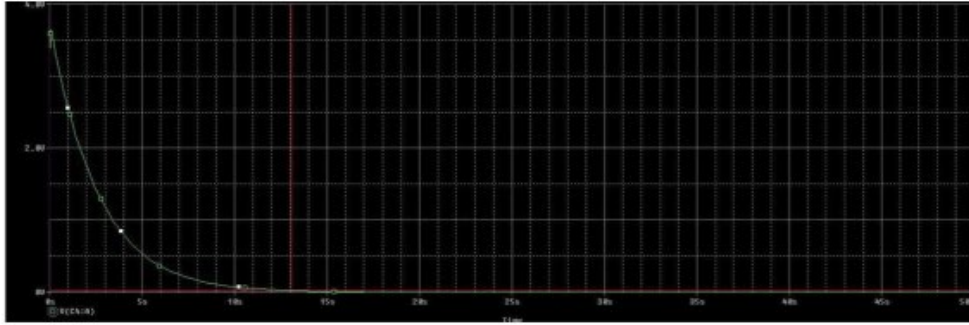
برای اندازه گیری ولتاژ اولیه مانند شکل بالا ولتاژ حالت پایدار خازن C1 را اندازه گیری کردیم که همانطور که در شکل زیر می بینید حدود ۳٫۷۸ ولت شد.



برای اندازه گیری خازن معادل هم یک مقاومت یک اهم به دو سر مدار مانند شکل زیر وصل کردیم:



حالا زمان به تعادل رسیدن مدار تقریبا پنج برابر ثابت زمانی مدار می باشد و چون مقدار مقاومت برابر یک اهم است مقدار خازن معادل همان ثابت زمانی مدار می شود که به راحتی محاسبه می شود.



$$5 \times \tau = 5 \times C = 12.8$$

ابتدا برای ساختن مقاومت غیرخطی از منبع جریان وابسته به ولتاژ استفاده میکنیم.

$CCS23$ یک منبع جریان وابسته به ولتاژ می باشد که مشخصه جریان عبوری از آن به صورت یک چند جمله ای از دو ولتاژ ورودی آن مشخص می شود. (ولتاژ های ورودی توسط *voltagesense* اندازه گیری می شوند)

حالا ما اینجا می خواهیم مشخصه $i = v_1^2$ را بسازیم پس یک ورودی را صفر قرار می دهیم و ضریب متناظر با ورودی اول به توان دو را برابر منفی یک قرار می دهیم. (به جهت دقت کنید)

Property

VALUE<expression>

Indicates the expression used to calculate the output current. The expression used is:

$$\text{GAIN} * (C_0 + C_1 \cdot I_1 + C_2 \cdot I_2 + C_3 \cdot I_1^2 + C_4 \cdot I_1 \cdot I_2 + C_5 \cdot I_2^2 + C_6 \cdot I_1^3 + C_7 \cdot I_1^2 \cdot I_2 + C_8 \cdot I_1 \cdot I_2^2 + C_9 \cdot I_2^3)$$

where

GAIN is the value of the GAIN property

C_0 is the value of the C0_VALUE property

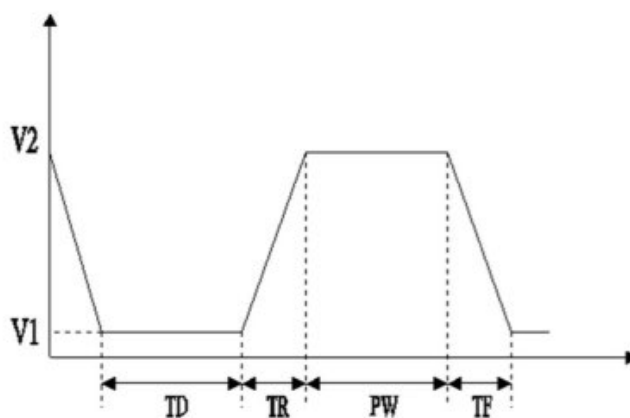
C_1 is the value of the C1_VALUE property

C_2 is the value of the C2_VALUE property

and so on

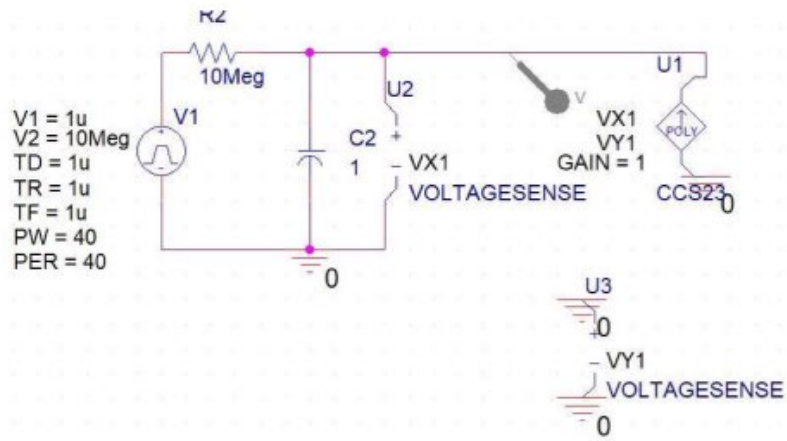
شکل بالا عبارت کلی را نشان می دهد.

برای ساختن منبع ضربه هم از *VPULSE* استفاده می کنیم و دوره را به مقدار متناسب کم می کنیم و ارتفاع آن را متناسب با معکوس دوره زیاد می کنیم و تناوب سیگنال را هم آنقدر بزرگ در نظر می گیریم که در بازه مورد نظر فقط یک ضربه اتفاق بیافتد.

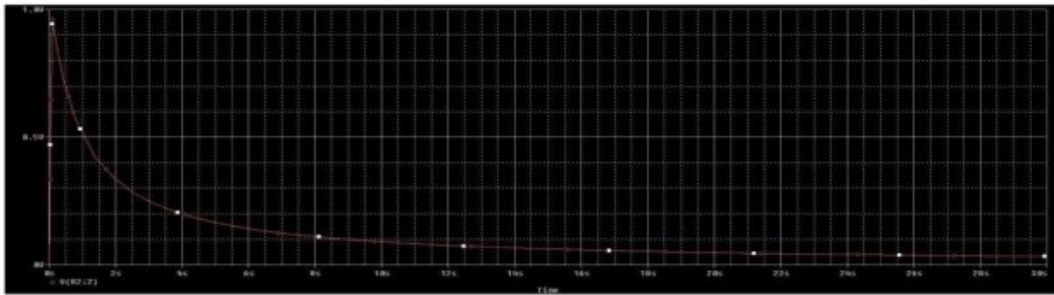


حال مدار را مانند شکل زیر می بندیم و پاسخ پله و پاسخ ضربه آن را اندازه گیری می کنیم.

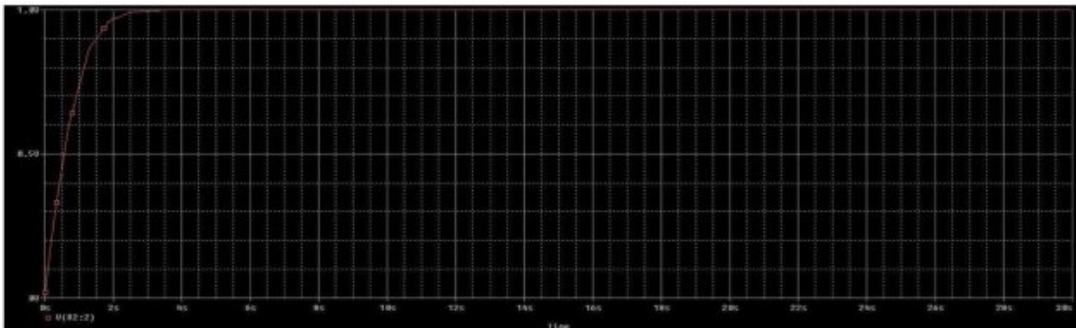
دقت کنید که به جای منبع جریان از یک منبع ولتاژ با مقاومت زیاد استفاده شده است که معادل یک منبع جریان می باشد.



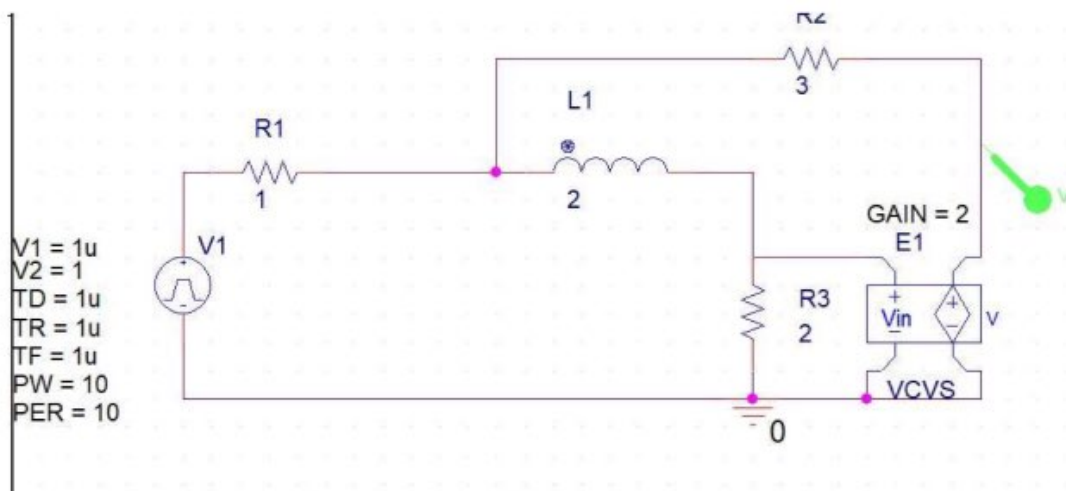
پاسخ ضربه



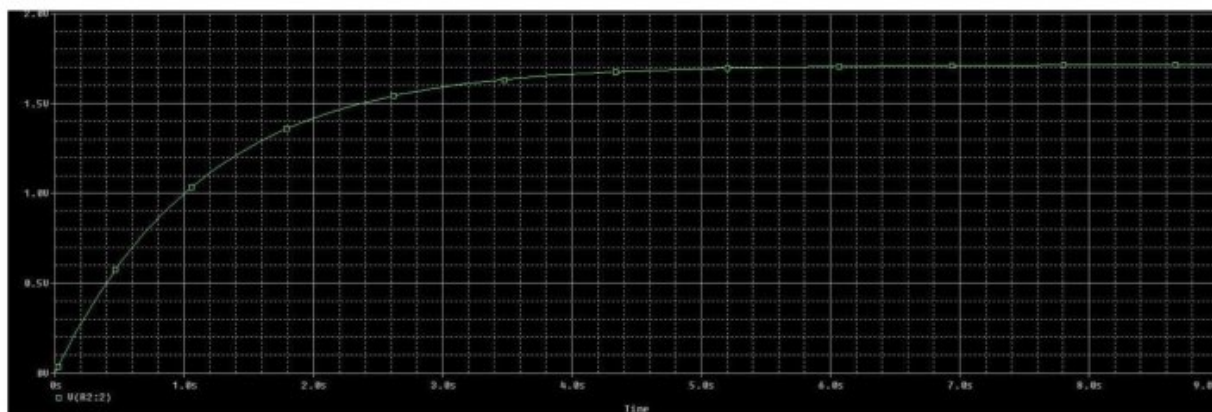
پاسخ پله



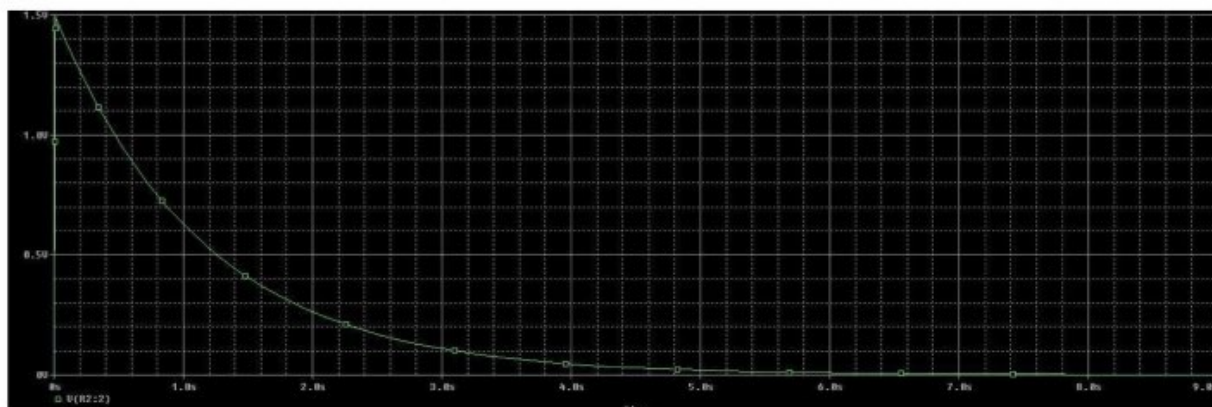
مدار را مانند شکل زیر می بندیم و پاسخ پله و ضربه آن را حساب می کنیم



پاسخ پله



پاسخ ضربه



سوال 17 : (دوستان عزیز دقت بفرمایید ! حل المسایل این سوال را **غلط** حل کرده است پس به حای حل المسایل اصلا اتکا نکنید!)

ابتدای کار در محیط Capture CIS (لازم به ذکر است تمامی حل ها و روش ها مربوط به ورژن 9.2 میباشد البته در ورژن های متفاوت تفاوت زیادی وجود ندارد اما ممکن است ظاهر نرم افزار تا حدی متفاوت باشد) سعی میکنیم شماتیک مدار داده شده در سوال را رسم نماییم البته به این موضوع دقت میکنیم برای اجزای مدار کافیسیت پس از افزودن کتابخانه های پی اسپایس آن ها را در پلیس پارت place part پیدا کرده و اضافه نماییم. (مقاومت : R سلف : L خازن : C)

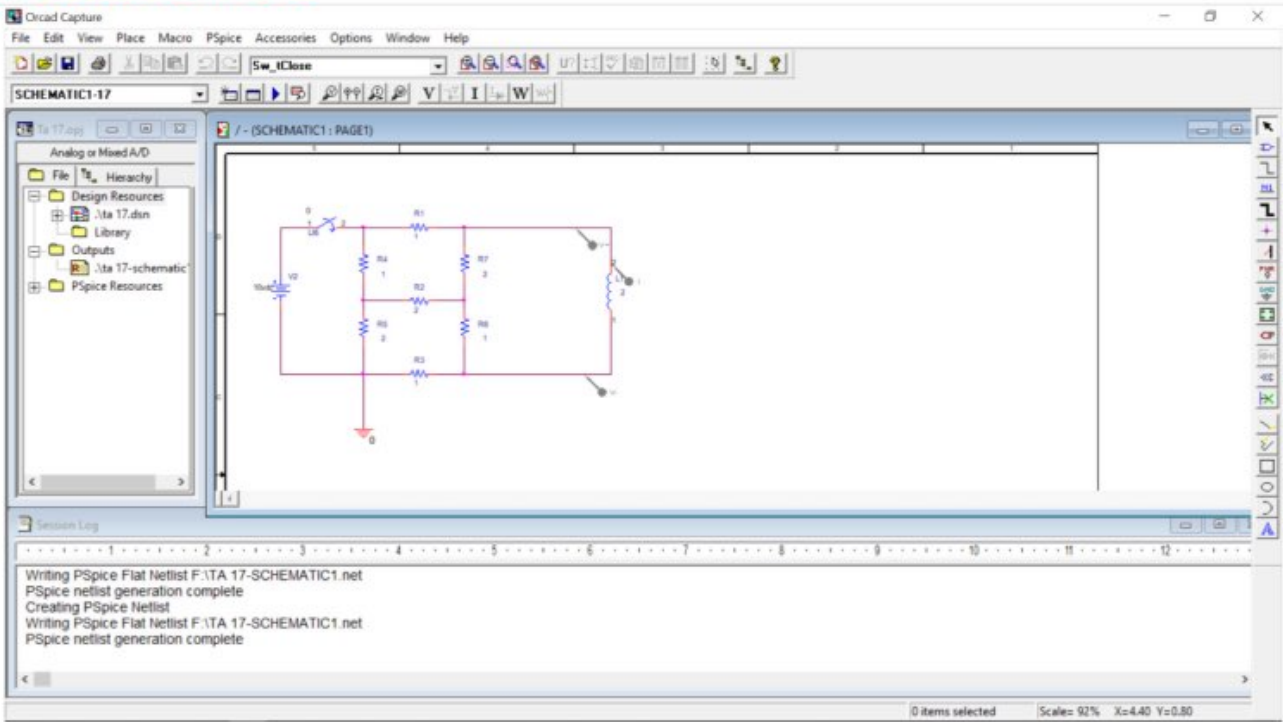
حال پس از رسم مدار کافیسیت یک سیمولیشن ساخته و در آن رفتار زمانی مدار را بررسی نماییم ما این کار را با سه پروب انجام میدهیم (هرچند برای حل سوال 1 پروب جریان کافیسیت) (شکل 1)

حل را به دو بخش تقسیم میکنیم

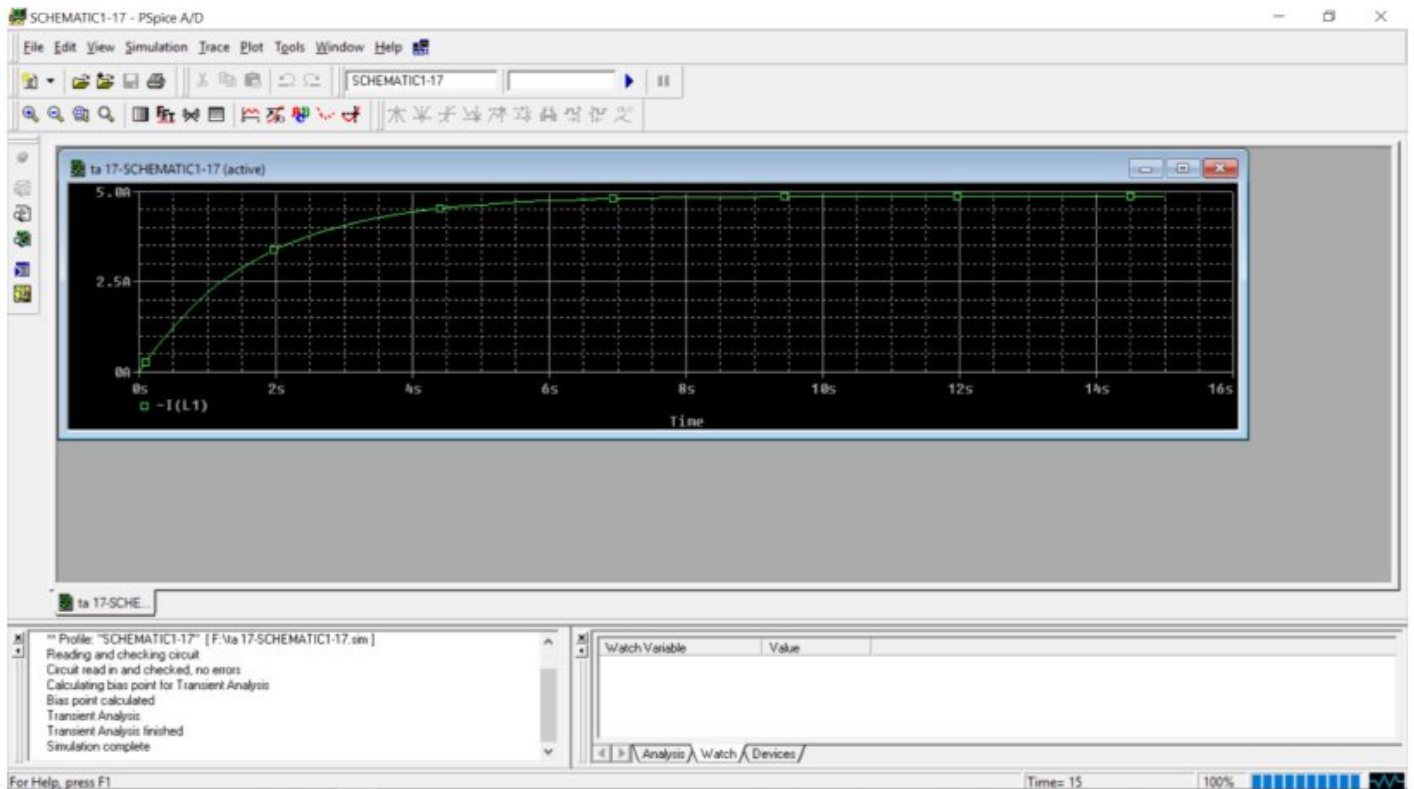
1: در لحظه ی 0 : این مقدار در نمودار ما پس از رسم نمودار جریان سلف برای ما به دست می آید (شکل 2) (نکته اضافه: با توجه به مقدار مقاومت و سلف میدانیم ثابت زمانی در اردر ثانیه خواهد بود پس مدت زمان را برای Time Domain حدود 15 ثانیه قرار میدهیم که تقریبا کل رفتار مدار برای ما مشخص باشد)

2: در لحظه ی بی نهایت: کافیسیت پس از ران کردن مدار مدت زمان را خیلی بزرگ قرار دهیم و در تنظیمات مشخص کنیم که به ما ماکسیمم را نشان دهد تا ببینیم در بی نهایت به چه شکل خواهد همچنین با مشخص کردن وی و آی ها در محیط شماتیک میتوان این کار را انجام داد (شکل 3 و 1 و 3 و 2)

مدار 1 تمرین شماره 5 | 4

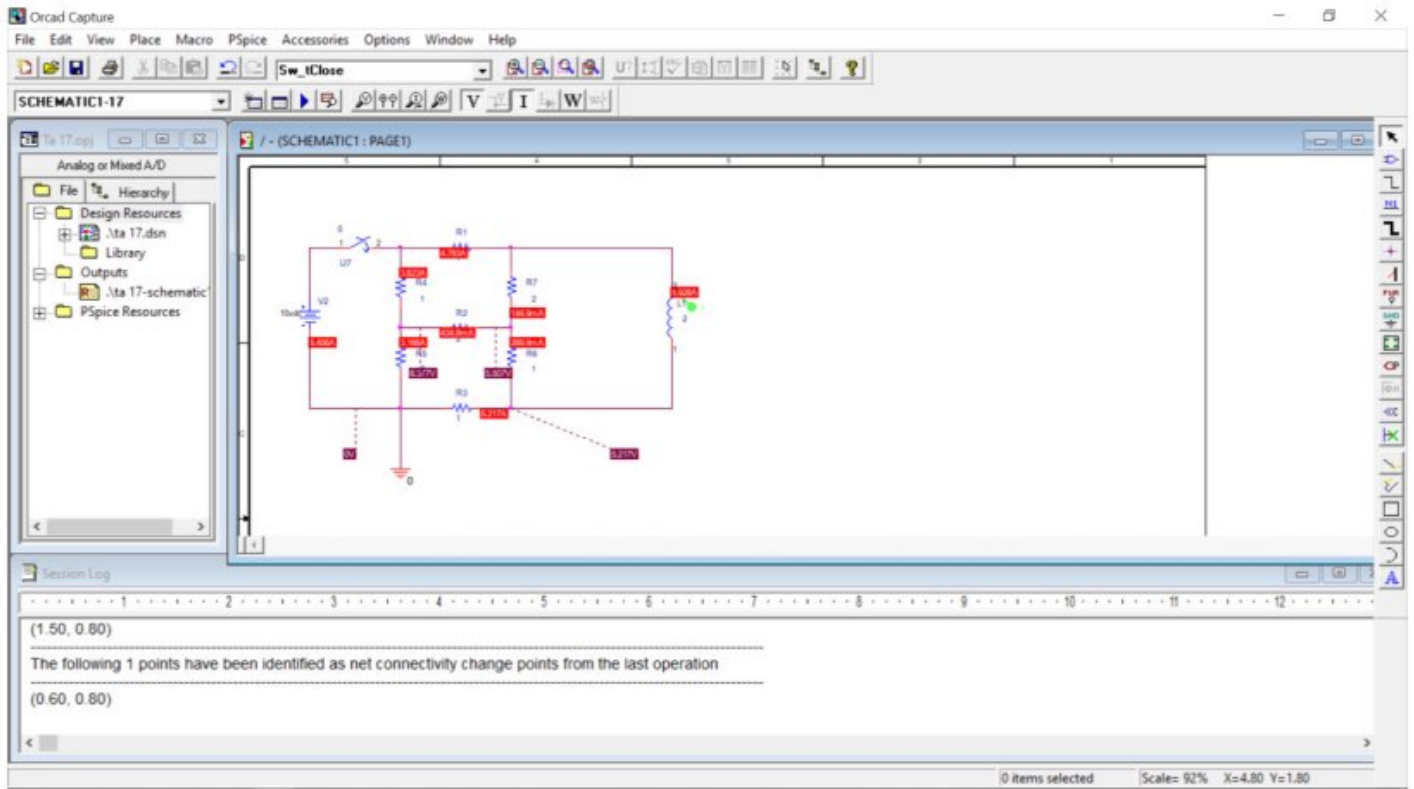
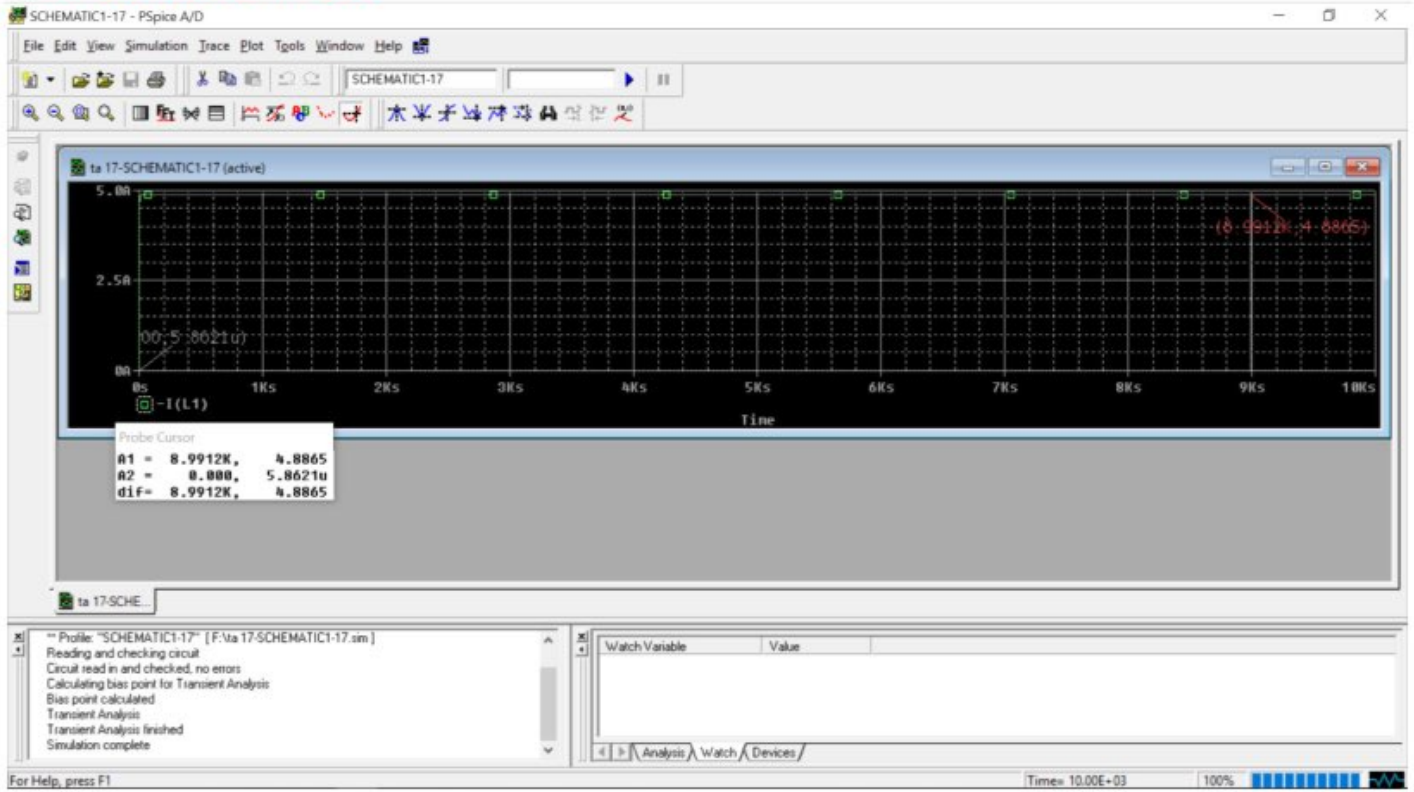


شکل 1: مدار داده شده در سوال



شکل 2

مدار 1 تمرین شماره 5 | 5



شکل 3.1 و 3.2

سوال 55: ابتدای کار در محیط Capture CIS سعی میکنیم شماتیک مدار داده شده در سوال را رسم نماییم البته به این موضوع دقت میکنیم برای اجزای مدار کافیسیت پس از افزودن کتابخانه های پی اسپایس آن ها را در پلیس پارت place part پیدا کرده و اضافه نماییم. (مقاومت : R سلف : L خازن : C)

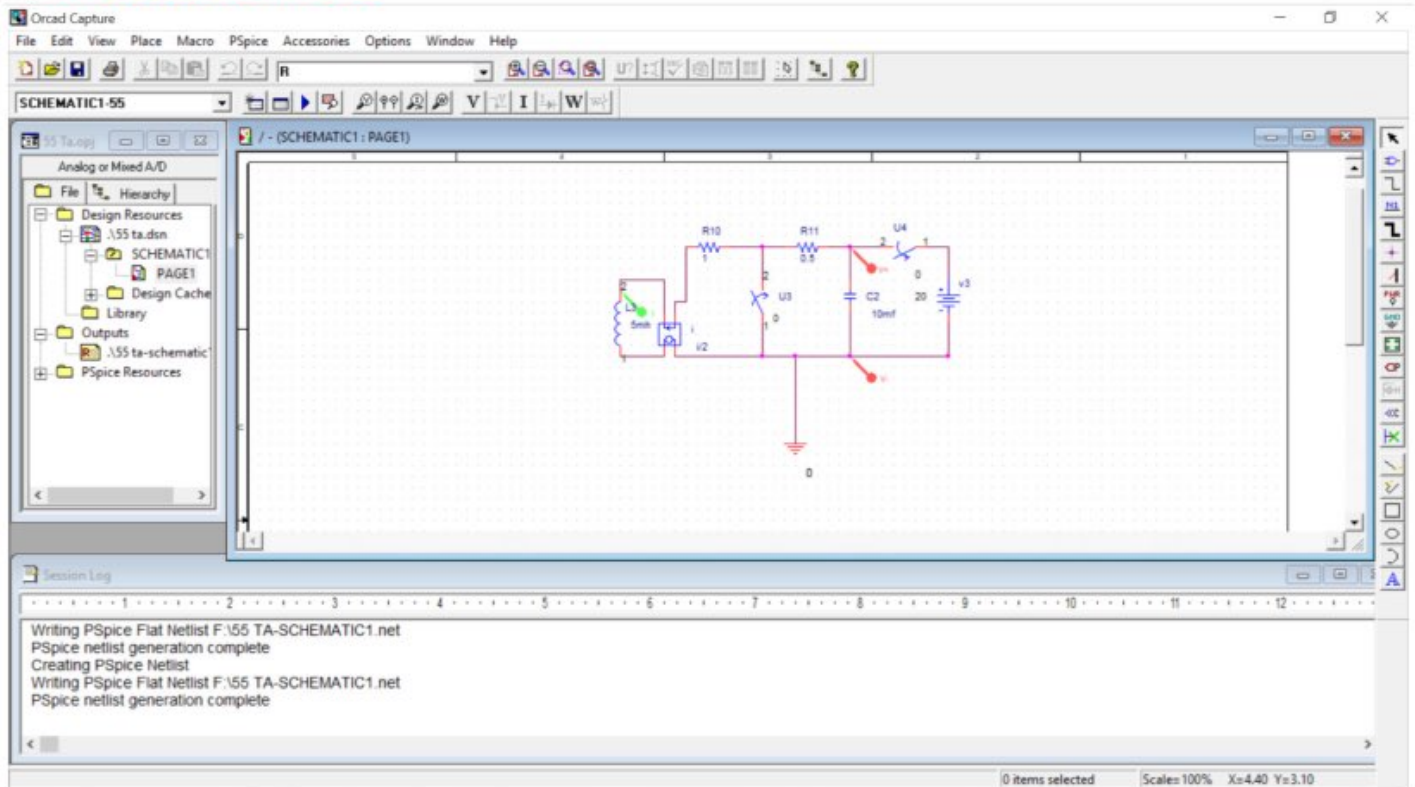
برای منبع ولتاژ کنترل شونده با جریان (CCVS) کافیسیت H را انتخاب نموده و مانند شکل 1 ببندیم

حال پس از رسم مدار کافیسیت یک سیمولیشن ساخته و در آن رفتار زمانی مدار را بررسی نماییم (با توجه به مقدار مقاومت و سلف و خازن ها ثابت زمانی در حدود صدم ثانیه خواهد بود پس کل مدت زمان را روی 0.05 ثانیه تنظیم مینماییم)

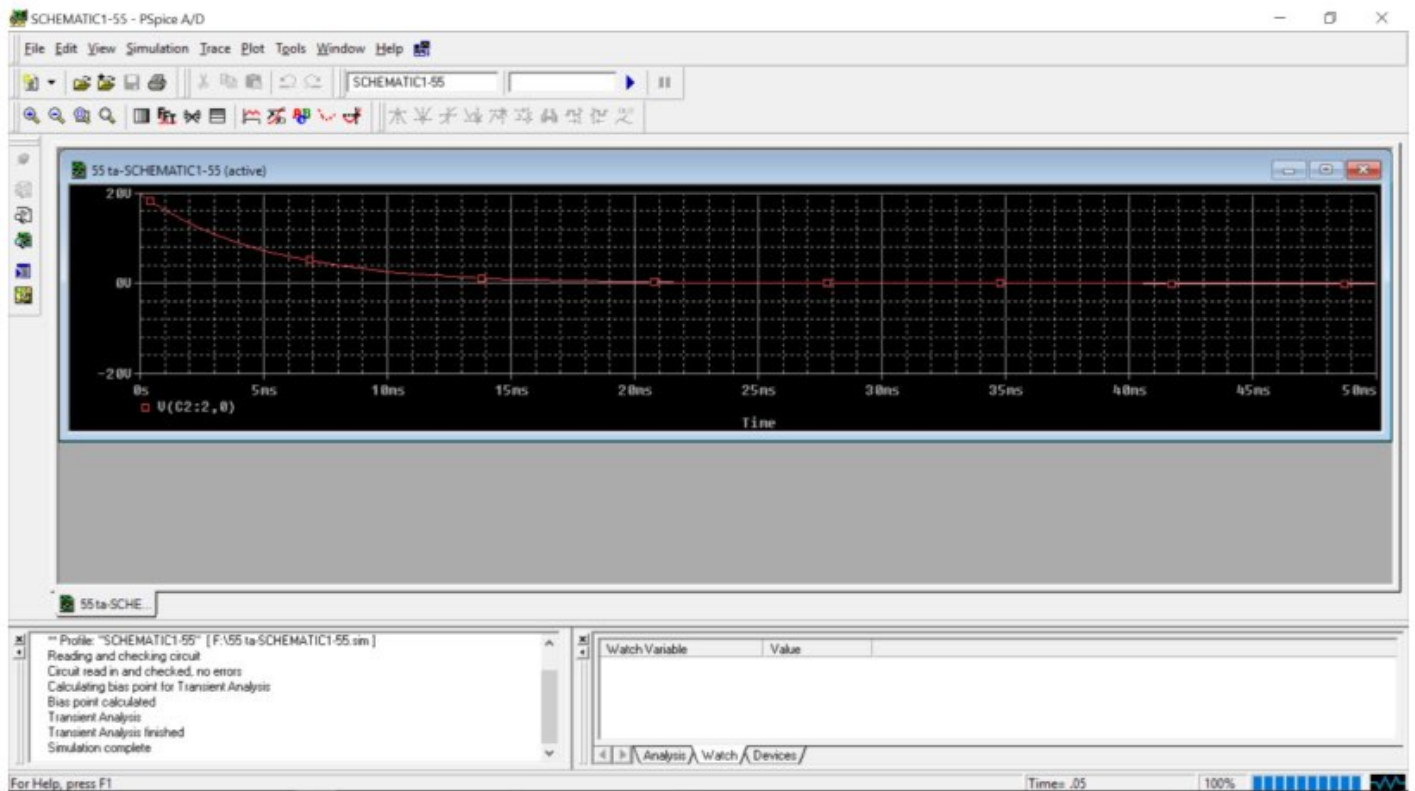
پیشنهاد میشود علاوه بر نوشتن کی وی ال ها پیش و پس از لحظه بسته شدن مدار، دانشجویان گرامی یک بار شماتیک مدار را رسم کرده و سعی کنند با روش متفاوتی از روش حل بنده سوال را در اسپایس حل کنند

(راهنمایی: با سرچ کردن سعی کنید شرایط اولیه را در مدار اعمال نمایید به عنوان مثال شرایط اولیه خازن 20 ولت)

مدار 1 تمرین شماره 5 | 7

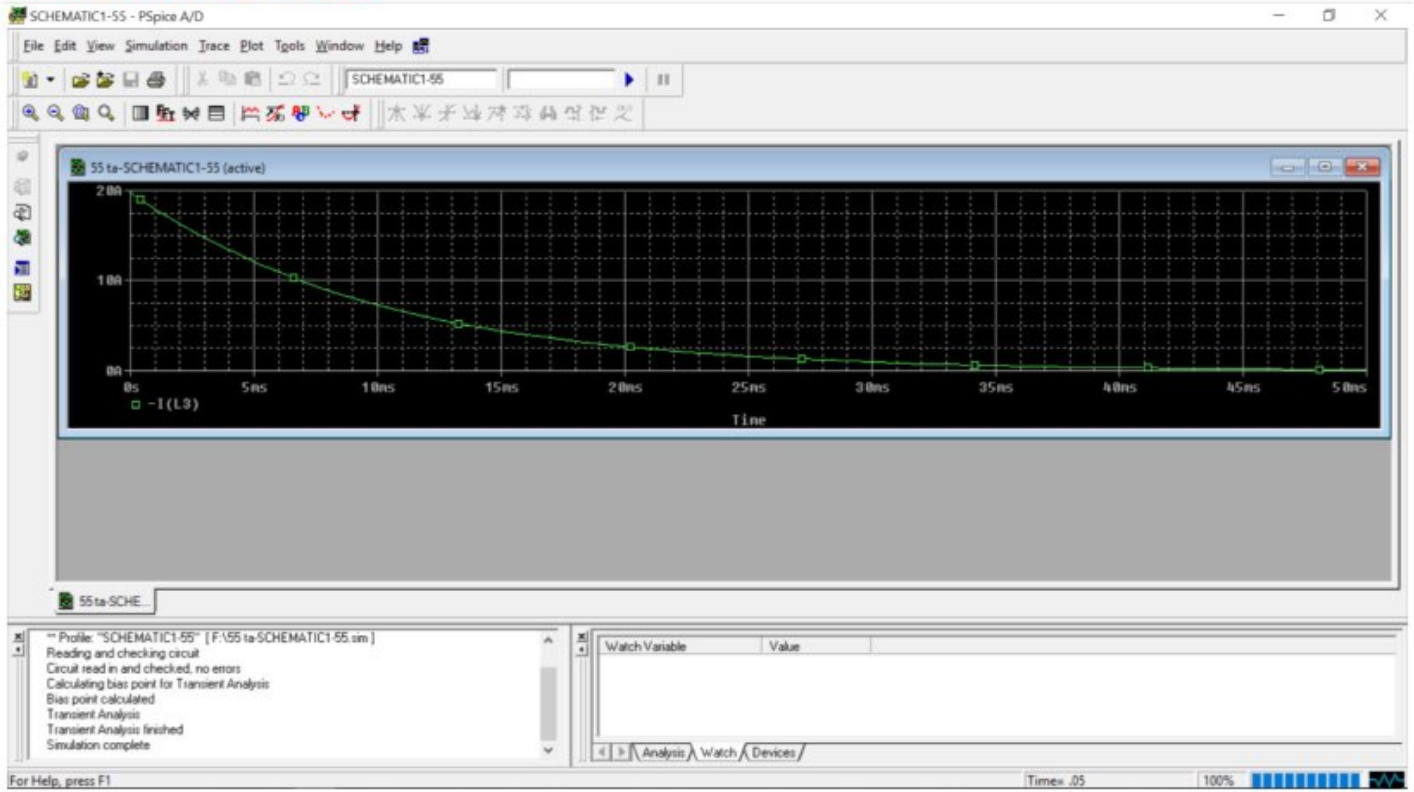


شکل 1: شماتیک مدار و محل پروب ها



شکل 2: ولتاژ دو سر خازن: همانطور که انتظار میرفت از 20 ولت به علت بسته بودن کلیدش شروع شد و با باز شدن کلید منبع ولتاژ دشارژ رخ داد

مدار 1 تمرین شماره 5 | 8



شکل 3: همانطور که انتظار میرفت، با نوشتن کی وی ال در لحظه 0 مثبت در بیرونی ترین حلقه، جریان ابتدایی از 2 آمپر شروع و با شارژ خازن به 0 میرسد

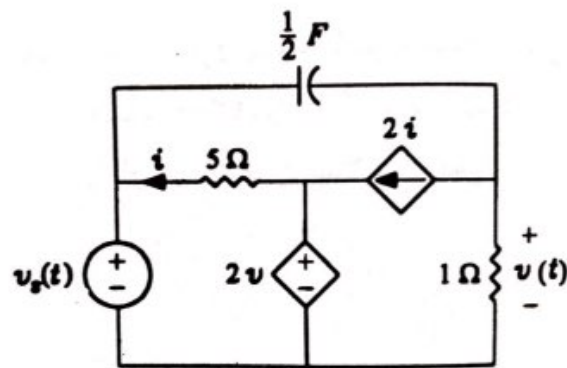
شبیه‌سازی سوالات ۳۸ و ۶۷ فصل چهارم کتاب جبه‌دار

تهیه‌کننده: سید مسعود معصومی‌زاده

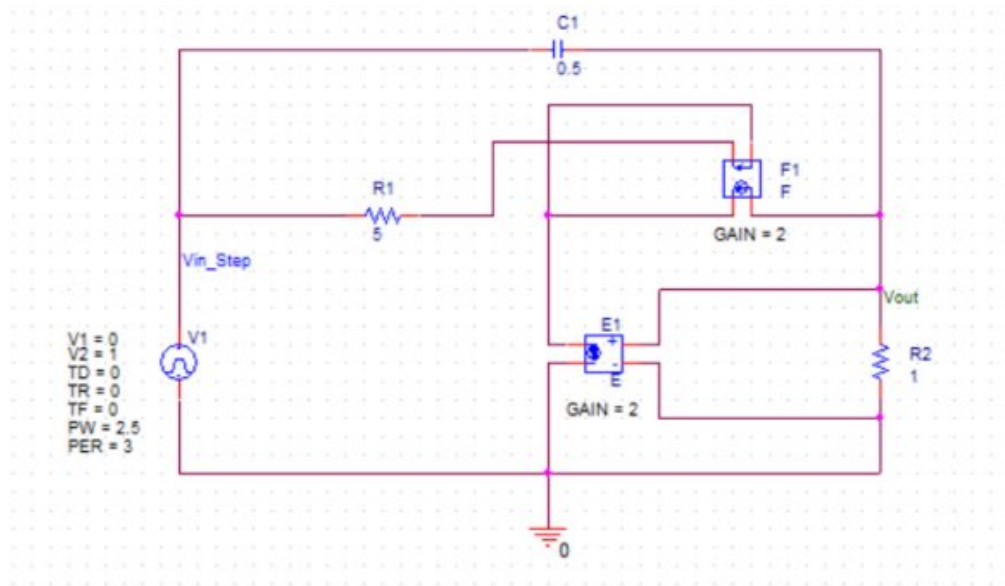
۲۲ فروردین ۱۳۹۹

۱ سوال ۳۸

در این سوال بررسی رفتار پاسخ پله‌ی یک مدار مرتبه اول مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکل مدار به صورت تصویر ۱ است. شماتیک ترسیمی برای این مدار در محیط اسپایس به صورت تصویر ۲ حاصل می‌شود. برای منبع جریان وابسته به جریان (CCCS) از المان F و برای منبع ولتاژ وابسته به ولتاژ (VCVS) از المان E از کتابخانه‌ی Analog استفاده شده است. همچنین برای ورودی پله، از منبع $VPULSE$ در کتابخانه‌ی Source استفاده شده است.



شکل ۱: مدار مسئله‌ی ۳۸



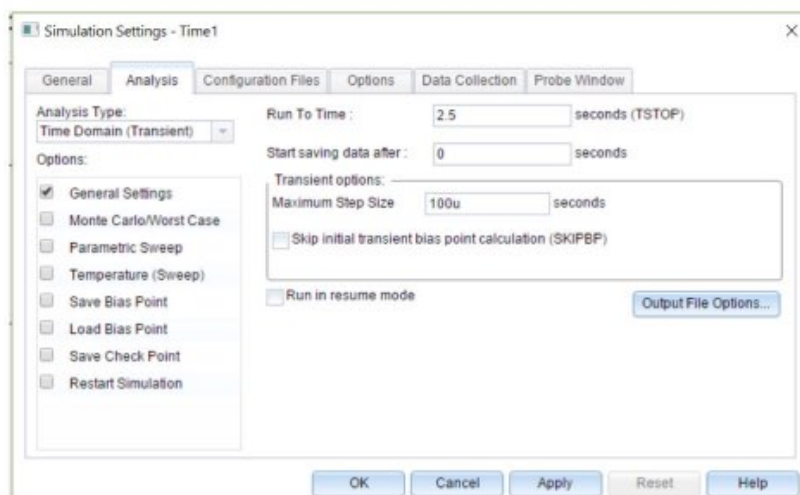
شکل ۲: شماتیک مدار در محیط اسپایس

برای مدار به صورت تئوری، مدار را در سه زمان متفاوت مورد بررسی قرار باید داد. اول برای لحظات $t < 0$ مدار را بررسی می‌کنیم. در این لحظات چون ورودی پالس صفر است (اتصال کوتاه) و هیچ ورودی دیگری وجود ندارد، جریان همه‌ی شاخه‌ها و ولتاژ گره‌ها صفر است در نتیجه ولتاژ خازن صفر می‌باشد. برای لحظات بسیار دور و در آینده ($t \rightarrow +\infty$) دوباره می‌توان خازن را مدار باز در نظر گرفت (زیرا خازن شارژ شده و هیچ تغییری در ولتاژ آن صورت نمی‌گیرد و بنابر رابطه‌ی $I_c = C \frac{dV_c}{dt}$ دیگر جریانی از آن نمی‌گذرد) و مدار را حل نمود. برای لحظه‌ی صفر که ورودی پله روشن می‌شود، باید از روی پیوستگی ولتاژ خازن استفاده نمود. مقدار ثابت زمانی نیز با دیدن مقاومت ورودی از دو سر خازن قابل محاسبه است. با طی این مراحل داریم:

$$\begin{cases} V_o(t) = V_{\text{final}} + (V_{\text{initial}} - V_{\text{final}}) e^{-\frac{t}{\tau}} \\ V_{\text{initial}} = 1 \\ V_{\text{final}} = \frac{2}{9} \\ \tau = RC = \frac{5}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{18} \simeq 0.27 [s] \end{cases} \Rightarrow V_o(t) = \left(\frac{2}{9} + \frac{7}{9} e^{-\frac{t}{0.27}} \right) u(t) \quad (1)$$

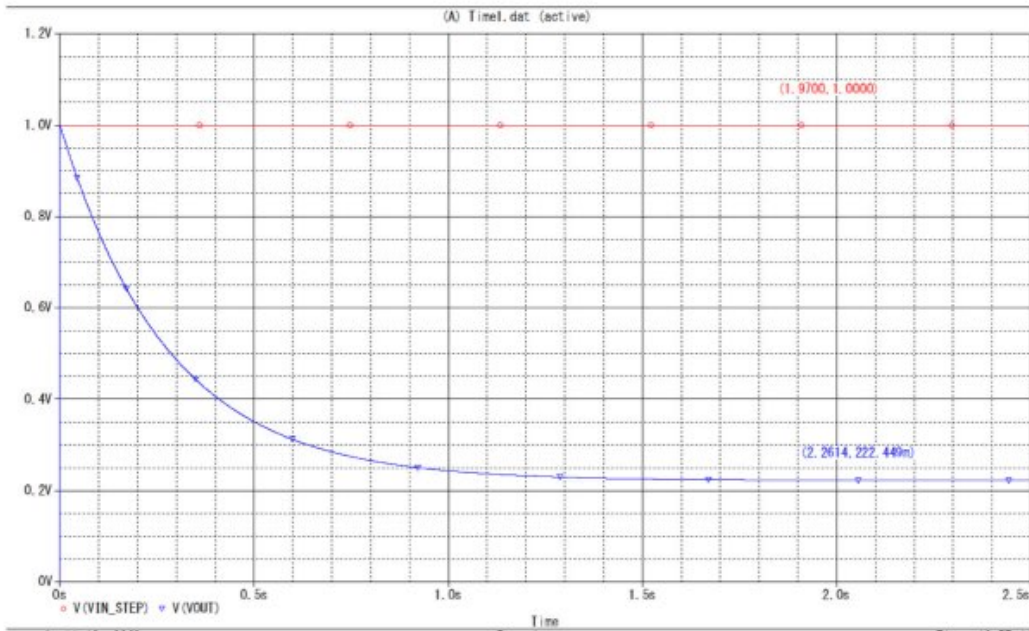
برای اینکه شبیه‌سازی در بازه‌ی زمانی درستی انجام شود، از آنجایی که مقدار ثابت زمانی در حدود ۰.۲۷ ثانیه است، شبیه‌سازی حداقل به اندازه‌ی ۵ برابر ثابت زمانی انجام شود ($5T$). در نتیجه منبع پالسی حداقل باید به این میزان مقدار یک را حفظ کند؛ فلذا دوره‌ی تناوب برابر با ۳ ثانیه و مقدار Pulse-Width آن (یعنی بازه‌ی زمانی از دوره‌ی تناوب که ورودی یک می‌ماند) ۲.۵ ثانیه

انتخاب شده‌اند تا ورودی شبیه به یک "ورودی پله‌ی واقعی" باشد. برای مشاهده‌ی رفتار زمانی مدار از تحلیل حوزه‌ی زمان (Time Domain Analysis) استفاده شده است. تصویر تنظیمات شبیه‌سازی به صورت شکل ۳ می‌باشد.

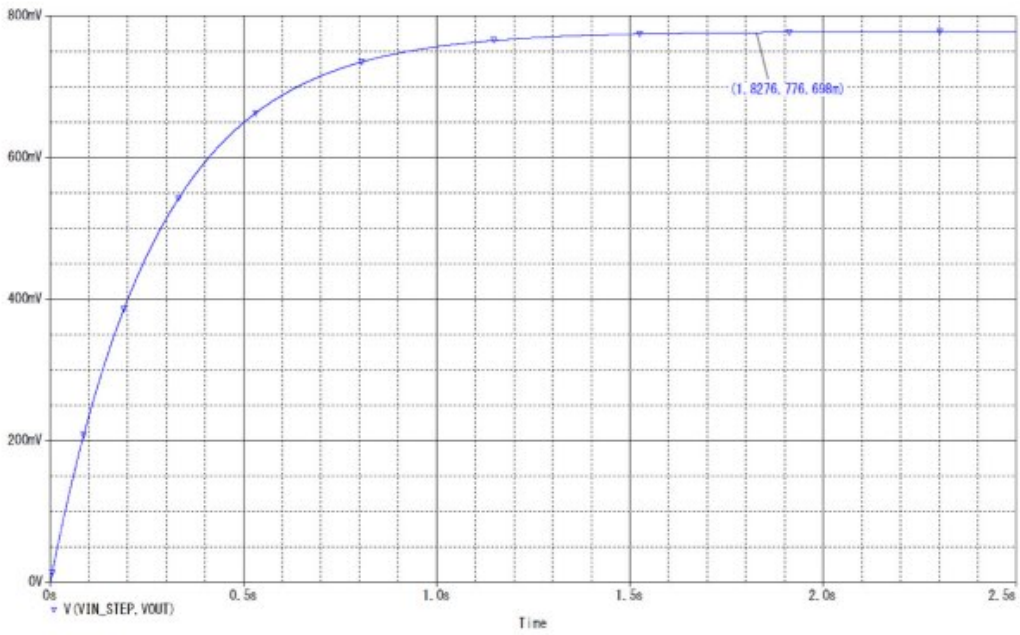


شکل ۳: تنظیمات تحلیل حوزه‌ی زمان

نتیجه‌ی شبیه‌سازی به صورت شکل ۴ بدست آمد. همان‌طور که دیده می‌شود رفتار کاملاً با رابطه‌ی (۱) همخوانی دارد. در لحظه‌ی صفر یک جهش از ولتاژ صفر به یک انجام شده است و سپس با ثابت زمانی محاسبه شده در حال کاهش است و به مقدار نهایی $0.22 \approx \frac{2}{9}$ ولت می‌رسد. ولتاژ خازن نیز به صورت شکل ۵ می‌باشد. همان‌طور که انتظار داشتیم ولتاژ خازن پیوسته است و با همان مقدار ثابت زمانی به مقدار نهایی $0.77 \approx \frac{7}{9}$ ولت می‌رسد.



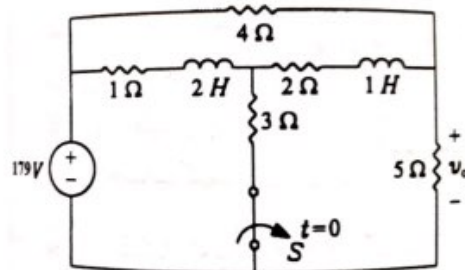
شکل ۴: ولتاژ خروجی



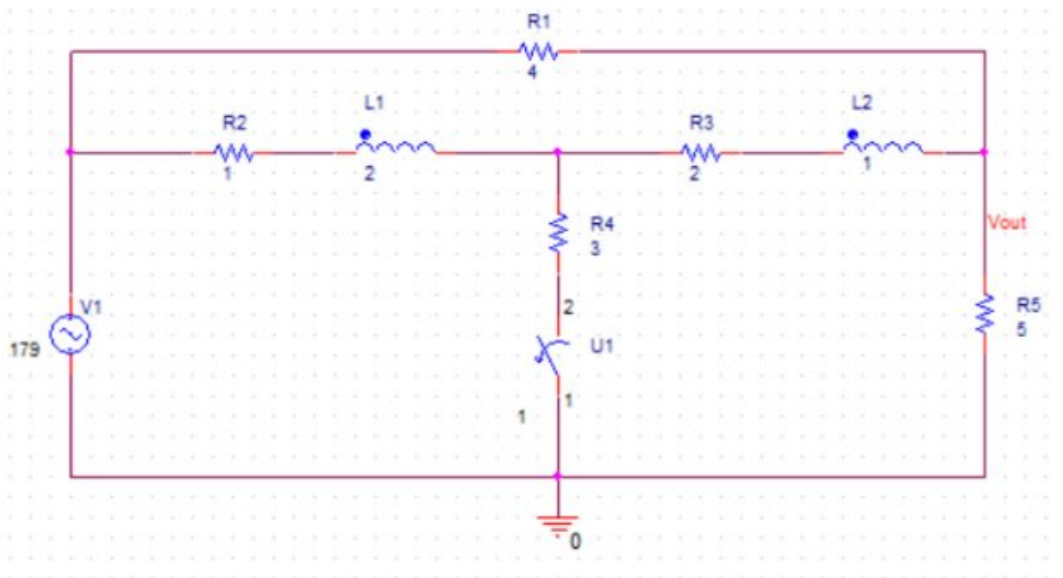
شکل ۵: ولتاژ خازن

۲ سوال ۶۷

مدار این مسئله نیز یک مدار مرتبه‌ی اول می‌باشد (شکل ۶). شماتیک مدار در محیط اسپایس به صورت شکل ۷ می‌باشد.



شکل ۶: مدار مسئله‌ی ۶۷



شکل ۷: شماتیک مدار در محیط اسپایس

مدار مشتمل بر ورودی DC، مقاومت، سلف و یک کلید می‌باشد. المان سلف از کتابخانه‌ی Analog و با نام L است. عنصر کلید نیز از کتابخانه‌ی ANL_MISC می‌باشد. در این کتابخانه کلیدهای متفاوتی موجود است که از پرکاربردترین آن‌ها می‌توان به sw_tOpen و sw_tClose اشاره نمود که به ترتیب "کلید در حال بسته شدن" و "کلید در حال باز شدن" می‌باشند. در

این مدار از کلید دوم (در حال باز شدن) استفاده می‌شود. با دوبار کلیک کردن روی این عنصر، می‌توان مشخصات آن را تغییر داد. همان‌طور که در شکل ۸ دیده می‌شود، زمان باز/بسته شدن کلید و مقاومت کلید در لحظات بسته و باز را می‌توان در این قسمت تنظیم نمود. بهتر است در حالت بسته مقاومت کمتر از ۰.۱ اهم و برای حالت باز بیشتر از ۱۰۰ مگا اهم باشد. همچنین زمان تغییر وضعیت کلید را می‌توان بسته به مدار تعیین نمود. در اینجا برای اینکه هیچ کلید زنی دیگری موجود نیست و برای مشاهده‌ی بهتر تغییر وضعیت و جهش ولتاژ و همچنین مشاهده‌ی حالت قبل از تغییر، به جای اینکه در لحظه‌ی صفر ثانیه تغییر وضعیت صورت گیرد، کلید را در لحظه‌ی ۱ ثانیه باز می‌کنیم. از آنجاییکه مدار Time-Invariant می‌باشد و مستقل از زمان است، پس تاخیر در باز شدن کلید در کل گره‌ها به یک میزان تاثیر خود را می‌گذارد و گویا تنها به اندازه‌ی یک ثانیه همه‌ی مقادیر و مشخصات مدار دارای Delay هستند.

| A | |
|-----------------------|-------------------------|
| | SCHEMATIC1 : PAGE1 |
| Implementation | Sw_tOpen |
| Implementation Type | PSpice Model |
| IO_LEVEL | |
| IOMODEL | |
| MNTYMXDLY | |
| Name | INS961 |
| Part Reference | U1 |
| Source Library | C:\CADENCE\SPB_17.2\... |
| Source Package | Sw_tOpen |
| PSpiceTemplate | X*@REFDES %1 %2 @MOD |
| PSpiceOnly | TRUE |
| Reference | U1 |
| Value | Sw_tOpen |
| VDC | |
| Location X-Coordinate | 530 |
| Location Y-Coordinate | 220 |
| RCLOSED | 0.01 |
| ROPEN | 100Meg |
| Source Part | Sw_tOpen.Normal |
| TOPEN | 1 |
| TTRAN | 1u |

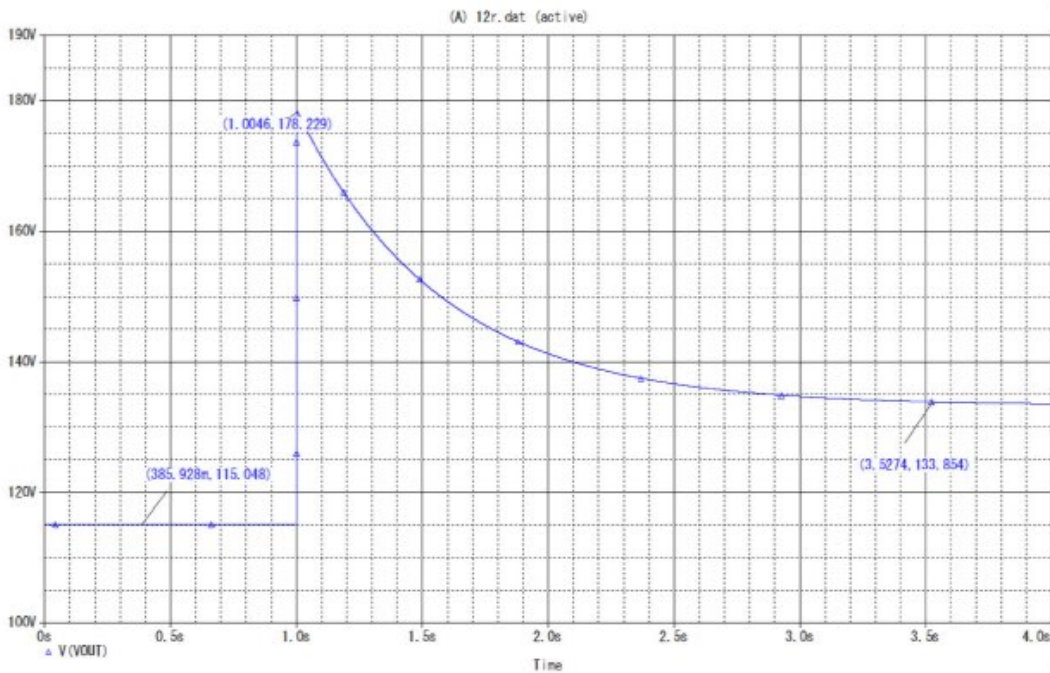
شکل ۸: مشخصات کلید

با حل تئوری مدار برای لحظات $t < 0$ و $(t \rightarrow +\infty)$ و با در نظرگیری این نکته که سلف‌ها اتصال کوتاه هستند، مدار را تحلیل می‌کنیم. در لحظه‌ی کلیدزنی باید بررسی شود که وضعیت جریان سلف‌ها چگونه است. از آنجاییکه سلف‌ها در $t < 0$ دارای جریان‌ها مختلفی هستند و در $t = 0+$ این دو المان سری می‌شوند، پس گسستگی در جریان این دو المان صورت می‌گیرد. به بیان دیگر ولتاژ ضربه‌ای روی دو سر این دو سلف می‌افتد و باعث این گسستگی می‌شود. ثابت زمانی نیز با دیدن مقاومت معادل

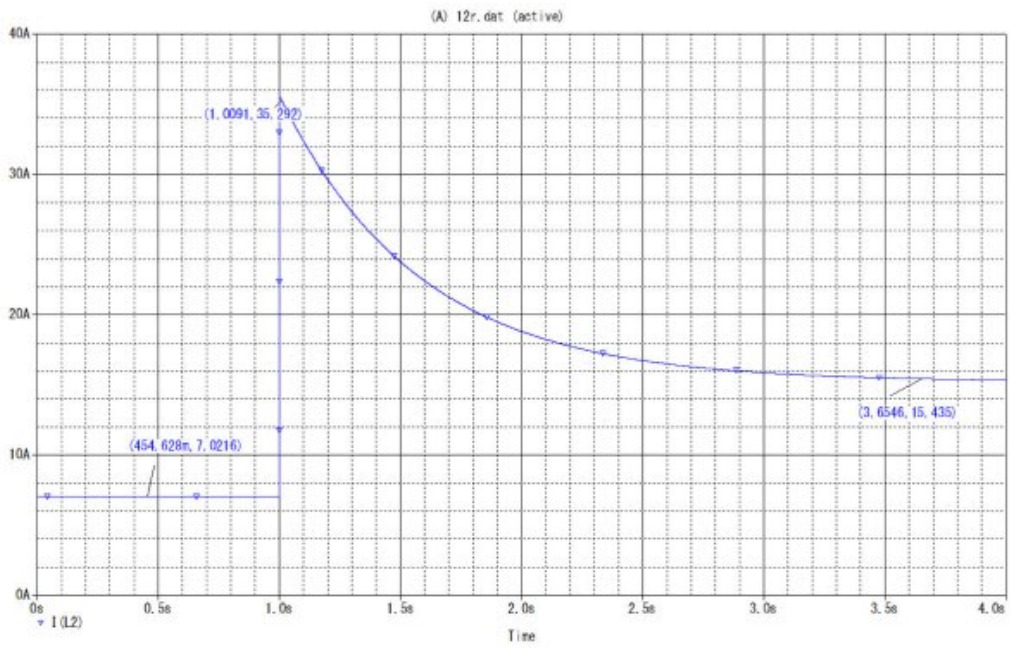
از دو سر سلف‌های سری شده (معادلاً ۳ هانری) قابل یافتن است. با طی این گام‌ها داریم:

$$\begin{cases} V_o(t) = V_{\text{final}} + (V_{\text{initial}} - V_{\text{final}}) e^{-\frac{t}{\tau}} \\ V_{o-} = 115 \text{ [v]} \\ V_{\text{initial}} = V_{o+} = \frac{4825}{27} \simeq 178,7 \text{ [v]} \\ V_{\text{final}} = \frac{6265}{47} \simeq 133,3 \text{ [v]} \\ \tau = \frac{L}{R} = 3 \times \frac{9}{47} = \frac{27}{47} \simeq 0,575 \text{ [s]} \end{cases} \Rightarrow V_o(t) = (133,3 + 45,4e^{-1,74t}) u(t) \quad (2)$$

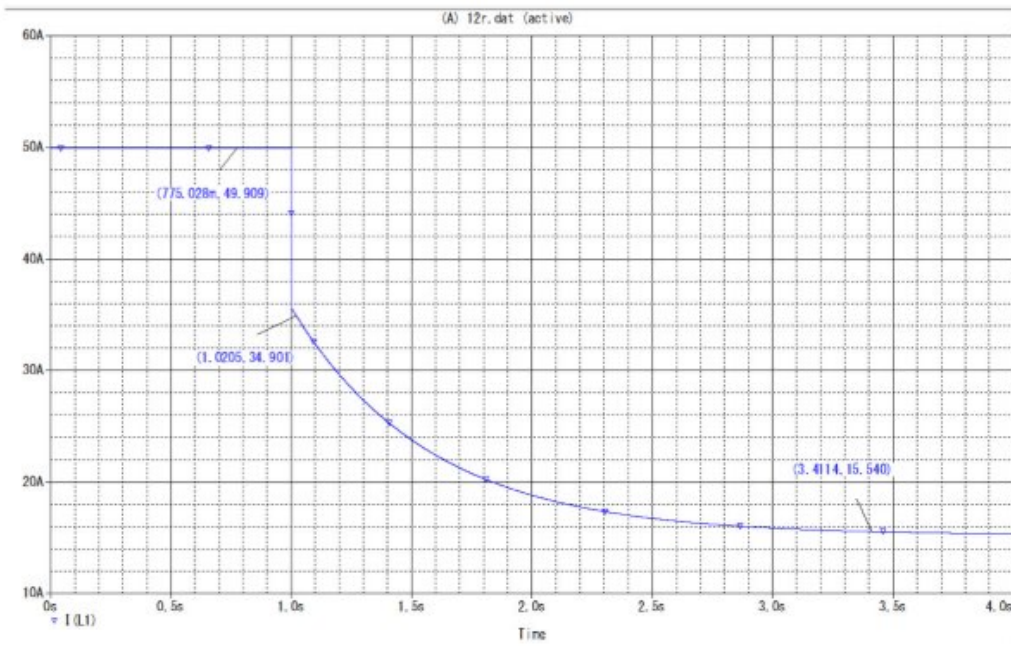
برای اینکه وضعیت تغییرات ولتاژها را کامل ببینیم، به اندازه‌ی ۵ ثابت زمانی حداقل باید شبیه‌سازی را انجام داد. به همین دلیل تحلیل به اندازه‌ی ۴ ثانیه ($4 \simeq 3,9 = 5\tau + 1$) انجام شده است. با انجام شبیه‌سازی نمودار ولتاژ خروجی به صورت شکل ۹ بدست آمد که با رابطه‌ی (۲) همخوانی دارد. جریان سلف‌ها و جهش انجام شده نیز به صورت شکل‌های ۱۰ و ۱۱ می‌باشد. رابطه‌ی جریان سلف‌ها نیز به صورت (۳) و (۴) است. L_1 سلف یک هانری و L_2 سلف دو هانری در نظر گرفته شده‌اند.



شکل ۹. ولتاژ خروجی



شکل ۱۰: جریان سلف یک هانری



شکل ۱۱: جریان سلف دو هانری

$$\begin{cases} I_{L,1}(t) = I_{L,1\text{final}} + (I_{L,1\text{initial}} - I_{L,1\text{final}}) e^{-\frac{t}{\tau}} \\ I_{L,1}(t = 0^-) = 7 \text{ [A]} \\ I_{L,1\text{initail}} = I_{L,1}(t = 0^+) = \frac{10V}{3} \simeq 3.33 \text{ [A]} \Rightarrow I_{L,1}(t) = (15.23 + 20.44e^{-1.74t}) u(t) \quad (3) \\ I_{L,1\text{final}} = \frac{71.6}{3V} \simeq 15.23 \text{ [A]} \\ \tau \simeq 0.575 \text{ [s]} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{L,1}(t) = I_{L,2}(t) & t \geq 0 \\ I_{L,2}(t = 0^-) = 50 \text{ [A]} & t < 0 \end{cases} \quad (4)$$

برای تاکید بیشتر توجه شود که روابط (۲)، (۳) و (۴) حل مدار سوال ۶۷ هستند اما شبیه‌سازی به اندازه‌ی یک ثانیه با تاخیر انجام شده است تا وضعیت پرش بهتر مشاهده شود. در واقع در روابط نامبرده برای شبیه‌سازی کفایت $t \rightarrow (t - 1)$ جایگزین شود.